



S-19110系列是使用CMOS技术开发的高精度电压检测IC。检测电压和解除电压在内部被固定，精度为±2.5%。工作时的消耗电流为600 nA (典型值)。

除电源端子外，在SENSE检测产品中另备有检测电压输入端子 (SENSE端子)，因而即使SENSE端子电压下降到0 V，也会保持输出稳定。

S-19110系列可以通过外接电容器来延迟检测信号和解除信号，检测延迟时间精度为±20% ( $C_N = 3.3 \text{ nF}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )，解除延迟时间精度为±20% ( $C_P = 3.3 \text{ nF}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )。

输出方式为N沟道开路漏极输出。

本公司可提供根据用户的使用条件而计算的FIT值，以支援用户设计应对功能安全标准的产品。

有关FIT值计算的实施详情，请向代理商咨询。

**注意** 本产品可适用于车辆器械、车载器械。考虑使用于车辆器械、车载器械时，请务必与代理商联系。

## ■ 特点

- 检测电压：  
J / K / L / M型 (VDD检测产品)： 3.6 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位)  
N / P / Q / R型 (SENSE检测产品)： 3.0 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位)
- 检测电压精度：  
±3.0% ( $-V_{DET(S)} = 3.0 \text{ V} \sim 4.15 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )  
±2.5% ( $-V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V} \sim 4.95 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )
- 检测延迟时间精度：  
±20% ( $C_N = 3.3 \text{ nF}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )
- 解除电压：  
J / K / L / M型 (VDD检测产品)： 3.8 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位)  
N / P / Q / R型 (SENSE检测产品)： 3.15 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位)
- 解除电压精度：  
±3.0% ( $-V_{DET(S)} = 3.0 \text{ V} \sim 4.15 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ ,  $5.0\% \leq V_{HYS} \leq 20.0\%$ )  
±3.5% ( $-V_{DET(S)} = 3.0 \text{ V} \sim 4.15 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ ,  $20.0\% < V_{HYS} \leq 30.0\%$ )  
±2.5% ( $-V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V} \sim 4.95 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ ,  $5.0\% \leq V_{HYS} \leq 20.0\%$ )  
±3.0% ( $-V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V} \sim 4.95 \text{ V}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ ,  $20.0\% < V_{HYS} \leq 30.0\%$ )
- 解除延迟时间精度：  
±20% ( $C_P = 3.3 \text{ nF}$ ,  $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )
- 消耗电流：  
600 nA (典型值)
- 工作电压范围：  
1.8 V ~ 36.0 V
- 滞后幅度\*1：  
可选择 "有" / "无"  
5.0% ~ 30.0% ( $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ )
- 输出方式：  
N沟道开路漏极输出
- 工作温度范围：  
 $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素
- 可耐受45 V抛负载
- 符合AEC-Q100标准\*2

\*1. 选择 "有" 时，滞后幅度可在5.0% ~ 30.0%的范围内设定。

\*2. 详情请与代理商联系。

## ■ 用途

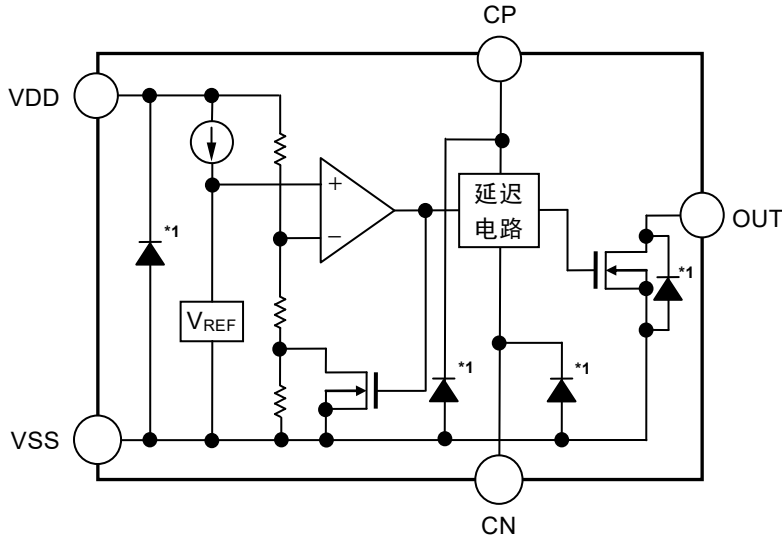
- 微机用电源的监视以及CPU的复位
- 与车载电池电压相关的电压检测
- 车载用 (引擎、变速器、汽车悬架、ABS、EV / HEV / PHEV关联器械等)

## ■ 封装

- SOT-23-6

■ 框图

1. S-19110系列J / K型 (VDD检测产品)

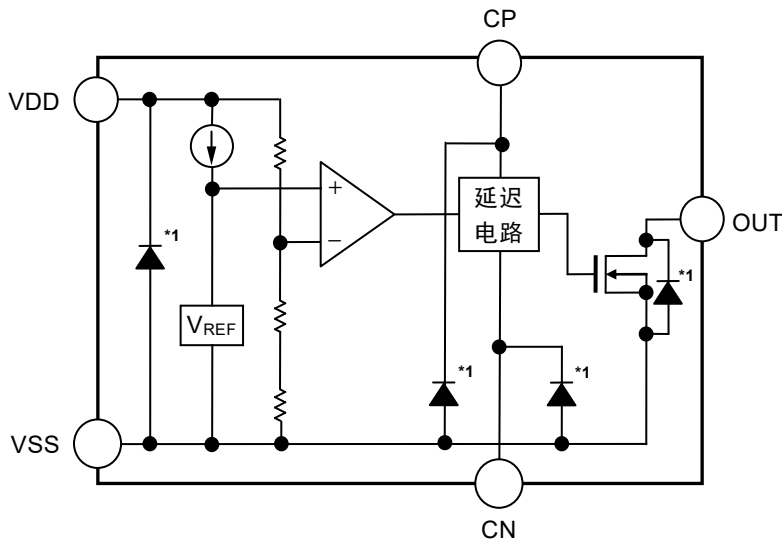


功能	状态
电压检测	VDD检测
滞后幅度	有

\*1. 寄生二极管

图1

2. S-19110系列L / M型 (VDD检测产品)

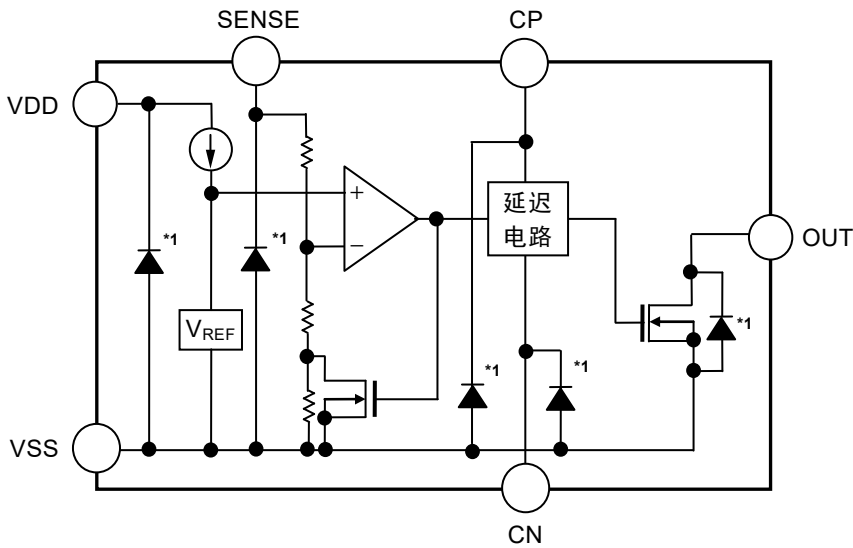


功能	状态
电压检测	VDD检测
滞后幅度	无

\*1. 寄生二极管

图2

3. S-19110系列N / P型 (SENSE检测产品)

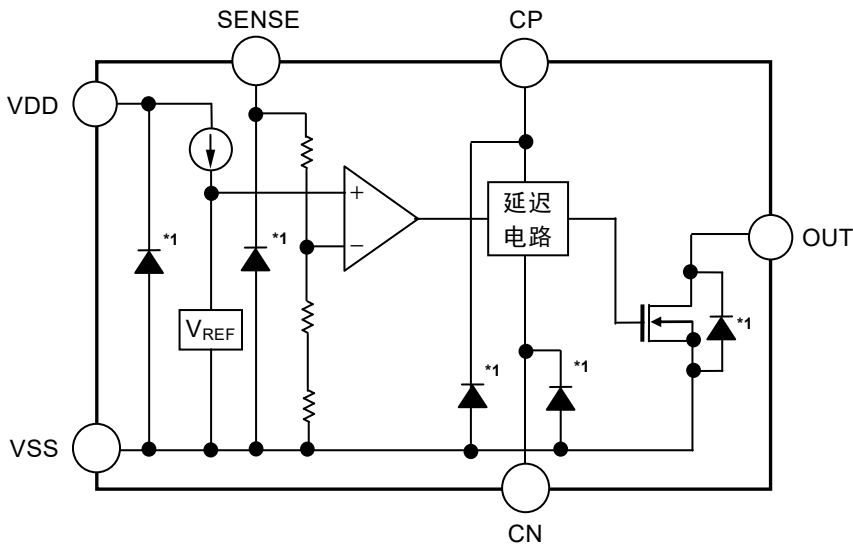


功能	状态
电压检测	SENSE检测
滞后幅度	有

\*1. 寄生二极管

图3

4. S-19110系列Q / R型 (SENSE检测产品)



功能	状态
电压检测	SENSE检测
滞后幅度	无

\*1. 寄生二极管

图4

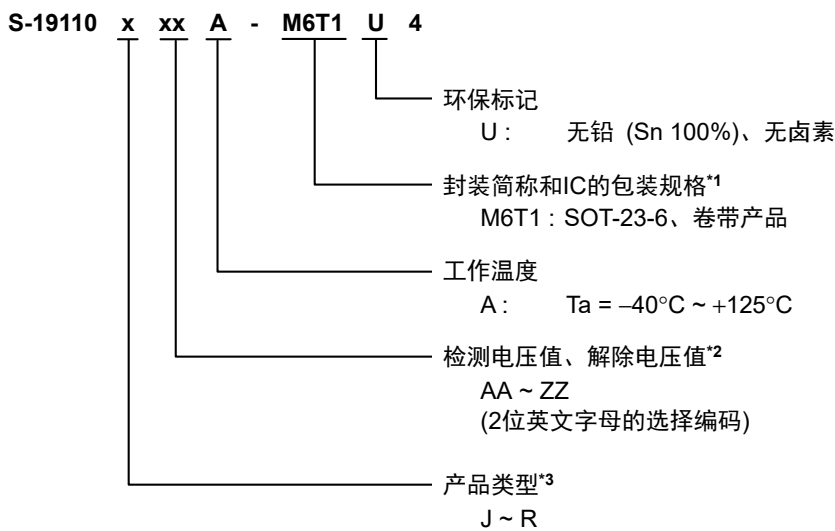
## ■ 符合AEC-Q100标准

本IC应对AEC-Q100标准的工作温度等级1。  
有关AEC-Q100标准的信赖性测试详情，请与代理商联系。

## ■ 产品型号名的构成

关于S-19110系列，用户可根据用途选择指定产品类型、检测电压值和解除电压值。  
关于产品名的字符串含义，请参阅 "1. 产品名"、关于产品类型请参阅 "2. 各产品类型的功能一览"、关于封装图纸请参阅 "3. 封装"。

### 1. 产品名



\*1. 请参阅卷带图。

\*2. 有关检测电压值、解除电压值的组合，请与代理商联系。

\*3. 请参阅 "2. 各产品类型的功能一览"。

**备注** 可在5.0% ~ 30.0%的范围内设定检测电压 ( $-V_{DET}$ ) 与解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 的差 (滞后幅度)。检测电压、解除电压的组合, 可从图5所示的A领域选择。

例:  $-V_{DET} = 3.0\text{ V}$ 时, 解除电压可以50 mV为进阶单位在3.15 V ~ 3.9 V的范围内设定。

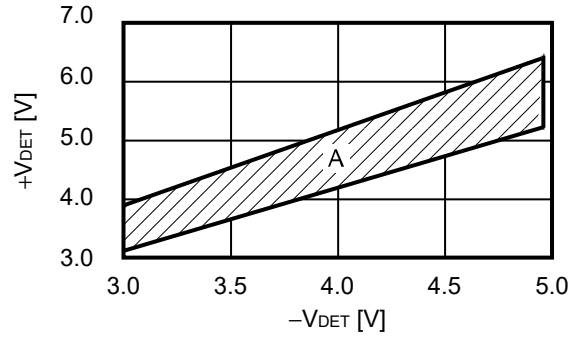


图5 检测电压、解除电压可设领域

## 2. 各产品类型功能一览

表1

产品类型	电压检测	输出逻辑	滞后幅度
J	VDD检测	动态 "L"	有
K	VDD检测	动态 "H"	有
L	VDD检测	动态 "L"	无
M	VDD检测	动态 "H"	无
N	SENSE检测	动态 "L"	有
P	SENSE检测	动态 "H"	有
Q	SENSE检测	动态 "L"	无
R	SENSE检测	动态 "H"	无

## 3. 封装

表2 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图
SOT-23-6	MP006-A-P-SD	MP006-A-C-SD	MP006-A-R-SD

## ■ 引脚排列图

### 1. S-19110系列J / K / L / M型 (VDD检测产品)

#### 1.1 SOT-23-6

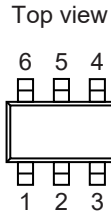


图6

表3

引脚号	符号	描述
1	VDD	电压输入端子
2	NC*1	无连接
3	OUT	电压检测输出端子
4	CP*2	解除延迟用电容器连接端子
5	VSS	接地 (GND) 端子
6	CN*3	检测延迟用电容器连接端子

- \*1. NC表示从电气角度而言处于开放状态。  
所以，与VDD端子以及VSS端子相接均可。
- \*2. 在CP端子和VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整解除延迟时间。  
并且，CP端子处于开路状态时也可使用。
- \*3. 在CN端子和VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整检测延迟时间。  
并且，CN端子处于开路状态时也可使用。

### 2. S-19110系列N / P / Q / R型 (SENSE检测产品)

#### 2.1 SOT-23-6

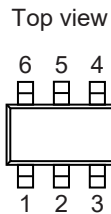


图7

表4

引脚号	符号	描述
1	VDD	电压输入端子
2	SENSE	检测电压输入端子
3	OUT	电压检测输出端子
4	CP*1	解除延迟用电容器连接端子
5	VSS	接地 (GND) 端子
6	CN*2	检测延迟用电容器连接端子

- \*1. 在CP端子和VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整解除延迟时间。  
并且，CP端子处于开路状态时也可使用。
- \*2. 在CN端子和VSS端子间连接电容器。通过此电容，可调整检测延迟时间。  
并且，CN端子处于开路状态时也可使用。

## ■ 绝对最大额定值

表5

(除特殊注明以外 : Ta = -40°C ~ +125°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
电源电压	$V_{DD} - V_{SS}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 45$	V
SENSE端子输入电压	$V_{SENSE}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 45$	V
CP端子输入电压	$V_{CP}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3 \leq V_{SS} + 7.0$	V
CN端子输入电压	$V_{CN}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{DD} + 0.3 \leq V_{SS} + 7.0$	V
输出电压	$V_{OUT}$	$V_{SS} - 0.3 \sim V_{SS} + 45$	V
输出电流	$I_{OUT}$	25	mA
工作环境温度	$T_{opr}$	-40 ~ +125	°C
保存温度	$T_{stg}$	-40 ~ +150	°C

**注意** 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性的损伤。

## ■ 热敏电阻值

表6

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
结至环境热阻*1	$\theta_{JA}$	SOT-23-6	Board A	-	159	-	°C/W
			Board B	-	124	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	-	-	°C/W

\*1. 测定环境 : 遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准

**备注** 关于详情, 请参阅 "■ Power Dissipation" 和 "Test Board"。

■ 电气特性

1. VDD检测产品

表7

(除特殊注明以外：Ta = -40°C ~ +125°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路	
检测电压*1	-V <sub>DET</sub>	3.6 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1	
		4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	1	
解除电压*2	+V <sub>DET</sub>	J / K型 5.0% ≤ V <sub>HYS</sub> ≤ 20.0%*3	3.6 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	1
		J / K型 20.0% < V <sub>HYS</sub> ≤ 30.0%*3	3.6 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.965	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.035	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
		L / M型 V <sub>HYS</sub> = 0%*4	3.6 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	-
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	-
消耗电流	I <sub>SS</sub>	J / K / L / M型 V <sub>DD</sub> = -V <sub>DET</sub> - 0.1 V	-	0.60	1.60	μA	2	
		J / K型 V <sub>DD</sub> = +V <sub>DET</sub> + 0.1 V	-	0.60	1.60	μA	2	
工作电压	V <sub>DD</sub>	-	1.8	-	36.0	V	1	
输出电流	I <sub>OUT</sub>	输出晶体管 N沟道 V <sub>DS</sub> *5 = 0.05 V	V <sub>DD</sub> = 2.9 V, 动态 "L"	0.31	-	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 6.9 V, 动态 "H"	0.45	-	-	mA	3
泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	输出晶体管 N沟道	V <sub>DD</sub> = 30.0 V, V <sub>OUT</sub> = 30.0 V, 动态 "L"	-	-	2.0	μA	3
			V <sub>DD</sub> = 2.9 V, V <sub>OUT</sub> = 30.0 V, 动态 "H"	-	-	2.0	μA	3
检测延迟时间*6	t <sub>RESET</sub>	C <sub>N</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
解除延迟时间	t <sub>DELAY</sub>	J / K型*7 C <sub>P</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
		L / M型*8 C <sub>P</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
CP端子放电通态电阻	R <sub>CP</sub>	V <sub>DD</sub> = 6.9 V, V <sub>CP</sub> = 0.5 V	0.52	-	2.2	kΩ	-	
CN端子放电通态电阻	R <sub>CN</sub>	V <sub>DD</sub> = 2.9 V, V <sub>CN</sub> = 0.5 V	1.0	-	5.0	kΩ	-	

\*1. -V<sub>DET</sub>：实际检测电压值、-V<sub>DET(S)</sub>：设定检测电压值

\*2. +V<sub>DET</sub>：实际解除电压值、+V<sub>DET(S)</sub>：设定解除电压值

\*3. 滞后幅度可在5.0% ~ 30.0%的范围内设定，但设定范围超过20.0%时，解除电压的精度有差异。

\*4. 滞后幅度为"无"，故解除电压 = 检测电压。

\*5. V<sub>DS</sub>：输出晶体管的漏极、源极间电压。

\*6. 电源电压 (V<sub>DD</sub>) 到达解除电压之后，向V<sub>DD</sub>端子外加-V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V → -V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V的脉冲电压后，V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。

\*7. 向V<sub>DD</sub>端子外加+V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V → +V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压后，V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。

\*8. 向V<sub>DD</sub>端子外加-V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V → -V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压后，V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。



2. SENSE检测产品

表8

(除特殊注明以外：Ta = -40°C ~ +125°C)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路	
检测电压*1	-V <sub>DET</sub>	V <sub>DD</sub> = 16.0 V	3.0 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	1
解除电压*2	+V <sub>DET</sub>	N / P型 V <sub>DD</sub> = 16.0 V 5.0% ≤ V <sub>HYS</sub> ≤ 20.0%*3	3.0 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	1
		N / P型 V <sub>DD</sub> = 16.0 V 20.0% < V <sub>HYS</sub> ≤ 30.0%*3	3.0 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.965	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.035	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	+V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	+V <sub>DET(S)</sub>	+V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
		Q / R型 V <sub>DD</sub> = 16.0 V V <sub>HYS</sub> = 0%*4	3.0 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.15 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.970	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.030	V	1
			4.2 V ≤ -V <sub>DET(S)</sub> ≤ 4.95 V	-V <sub>DET(S)</sub> × 0.975	-V <sub>DET(S)</sub>	-V <sub>DET(S)</sub> × 1.025	V	1
消耗电流*5	I <sub>SS</sub>	N / P / Q / R型 V <sub>DD</sub> = 16.0 V, V <sub>SENSE</sub> = -V <sub>DET</sub> - 0.1 V	-	0.55	1.55	μA	2	
		N / P型 V <sub>DD</sub> = 16.0 V, V <sub>SENSE</sub> = +V <sub>DET</sub> + 0.1 V	-	0.55	1.55	μA	2	
工作电压	V <sub>DD</sub>	-	3.0	-	36.0	V	1	
输出电流	I <sub>OUT</sub>	输出晶体管 N沟道 V <sub>DS</sub> *6 = 0.05 V	V <sub>DD</sub> = 5.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 2.9 V, 动态 "L"	0.45	-	-	mA	3
			V <sub>DD</sub> = 5.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 6.9 V, 动态 "H"	0.45	-	-	mA	3
泄漏电流	I <sub>LEAK</sub>	输出晶体管 N沟道	V <sub>DD</sub> = 30.0 V, V <sub>OUT</sub> = 30.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 30.0 V, 动态 "L"	-	-	2.0	μA	3
			V <sub>DD</sub> = 30.0 V, V <sub>OUT</sub> = 30.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 2.9 V, 动态 "H"	-	-	2.0	μA	3
检测延迟时间*7	t <sub>RESET</sub>	C <sub>N</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
解除延迟时间	t <sub>DELAY</sub>	N / P型*8, C <sub>P</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
		Q / R型*9, C <sub>P</sub> = 3.3 nF	8.0	10.0	12.0	ms	4	
SENSE端子电阻	R <sub>SENSE</sub>	-	6.8	-	275	MΩ	-	
CP端子放电通态电阻	R <sub>CP</sub>	V <sub>DD</sub> = 3.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 6.9 V, V <sub>CP</sub> = 0.5 V	0.72	-	4.29	kΩ	-	
CN端子放电通态电阻	R <sub>CN</sub>	V <sub>DD</sub> = 3.0 V, V <sub>SENSE</sub> = 2.9 V, V <sub>CN</sub> = 0.5 V	0.72	-	4.29	kΩ	-	

- \*1. -V<sub>DET</sub> : 实际检测电压值、-V<sub>DET(S)</sub> : 设定检测电压值
- \*2. +V<sub>DET</sub> : 实际解除电压值、+V<sub>DET(S)</sub> : 设定解除电压值
- \*3. 滞后幅度可在5.0% ~ 30.0%的范围内设定, 但设定范围超过20.0%时, 解除电压的精度有差异。
- \*4. 滞后幅度为 "无", 故解除电压 = 检测电压。
- \*5. 不包括流入SENSE端子电阻的电流。
- \*6. V<sub>DS</sub> : 输出晶体管的漏极、源极间电压。
- \*7. 向V<sub>DD</sub>端子外加16.0 V, SENSE端子输入电压 (V<sub>SENSE</sub>) 到达解除电压之后, 向SENSE端子外加-V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V → -V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V的脉冲电压后, V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。
- \*8. 向V<sub>DD</sub>端子外加16.0 V, 向SENSE端子外加+V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V → +V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压后, V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。
- \*9. 向V<sub>DD</sub>端子外加16.0 V, 向SENSE端子外加-V<sub>DET(S)</sub> - 0.5 V → -V<sub>DET(S)</sub> + 0.5 V的脉冲电压后, V<sub>OUT</sub>到达V<sub>DD</sub> / 2的时间。

■ 测定电路

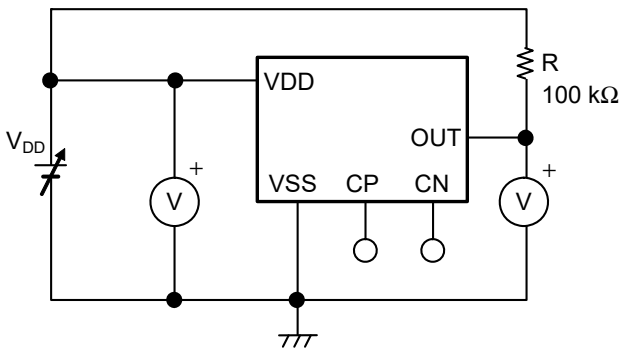


图8 测定电路1 (VDD检测产品)

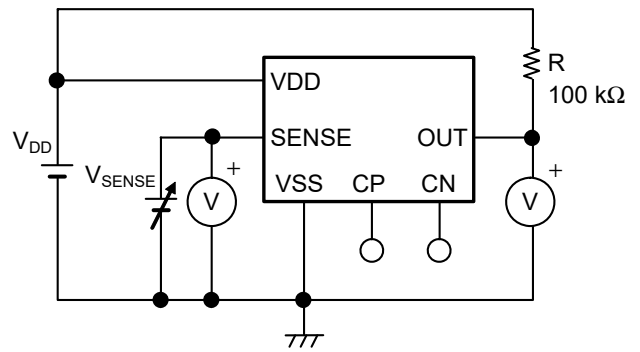


图9 测定电路1 (SENSE检测产品)

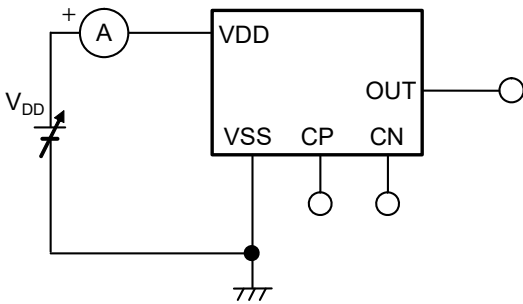


图10 测定电路2 (VDD检测产品)

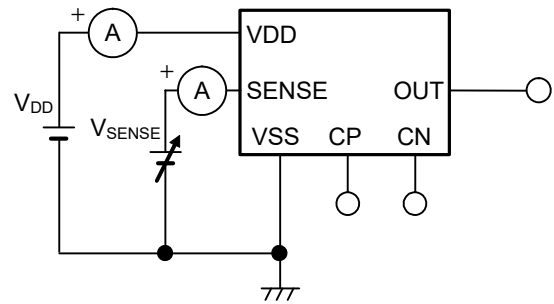


图11 测定电路2 (SENSE检测产品)

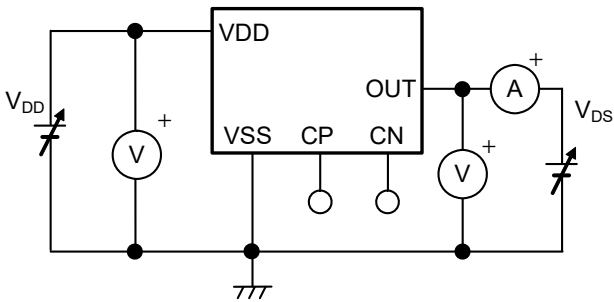


图12 测定电路3 (VDD检测产品)

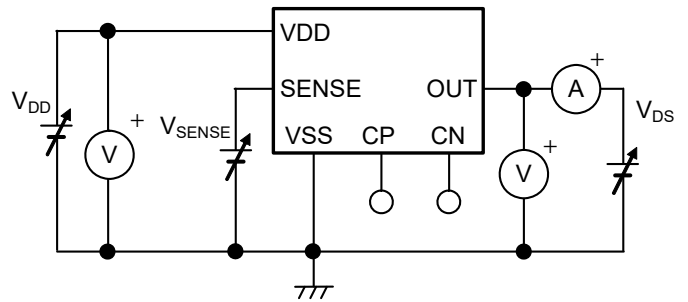


图13 测定电路3 (SENSE检测产品)

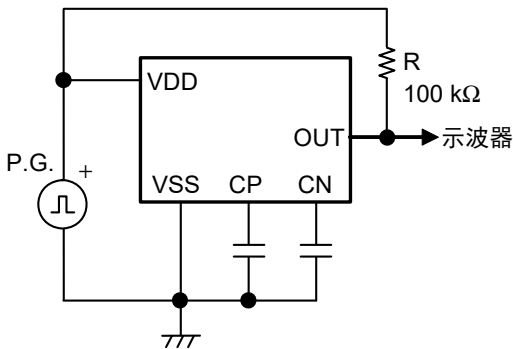


图14 测定电路4 (VDD检测产品)

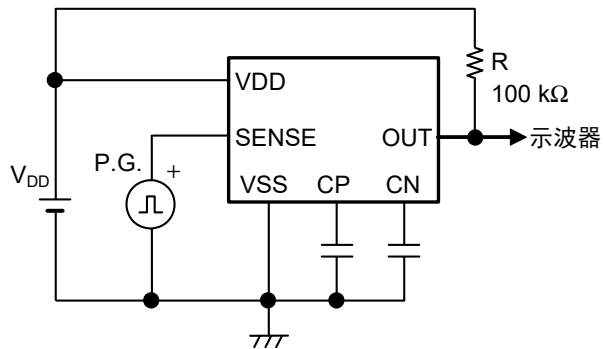
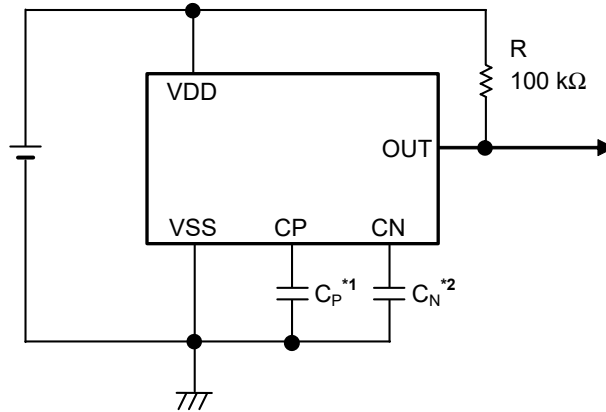


图15 测定电路4 (SENSE检测产品)

## ■ 标准电路

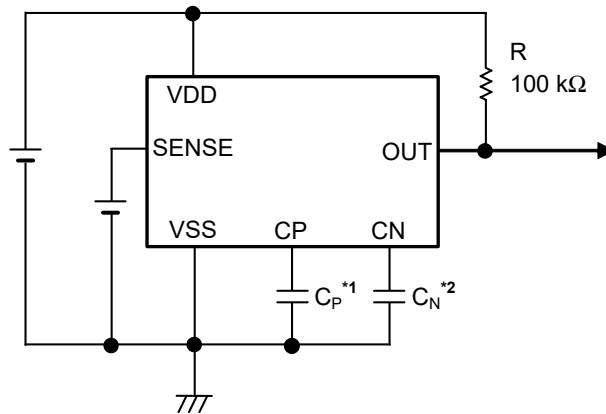
### 1. VDD检测产品



- \*1. 请将延迟用电容器 ( $C_P$ ) 直接与CP端子和VSS端子相连接。
- \*2. 请将延迟用电容器 ( $C_N$ ) 直接与CN端子和VSS端子相连接。

图16

### 2. SENSE检测产品



- \*1. 请将延迟用电容器 ( $C_P$ ) 直接与CP端子和VSS端子相连接。
- \*2. 请将延迟用电容器 ( $C_N$ ) 直接与CN端子和VSS端子相连接。

图17

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

## ■ 用语说明

### 1. 检测电压 ( $-V_{DET}$ )

检测电压是指图22、图23的输出在动态 "H" 时切换到 "H", 在动态 "L" 时切换到 "L" 的电压 (VDD检测产品 :  $V_{DD}$ 、SENSE检测产品 :  $V_{SENSE}$ )。

即使是同样的产品的检测电压也有不同程度的差异, 因此差异而引起的检测电压的最小值 ( $-V_{DET}$  (最小值)) 到最大值 ( $-V_{DET}$  (最大值)) 的范围称为检测电压范围 (参阅图18、图20)。

例 :  $-V_{DET} = 3.0\text{ V}$  产品的检测电压为  $2.910\text{ V} \leq -V_{DET} \leq 3.090\text{ V}$  的范围内的一点。  
也就是说, 既有  $-V_{DET} = 2.910\text{ V}$  的产品, 也有  $-V_{DET} = 3.090\text{ V}$  的产品。

### 2. 解除电压 ( $+V_{DET}$ )

解除电压是指图22、图23的输出在动态 "H" 时切换到 "L", 在动态 "L" 时切换到 "H" 的电压 (VDD检测产品 :  $V_{DD}$ 、SENSE检测产品 :  $V_{SENSE}$ )。

可在5.0% ~ 30.0%的范围内设定检测电压与解除电压的差 (参阅 "图5 检测电压、解除电压可设领域")。即使是同样的产品的解除电压也有不同程度的差异, 因此差异而引起的解除电压的最小值 ( $+V_{DET}$  (最小值)) 到最大值 ( $+V_{DET}$  (最大值)) 的范围称为解除电压范围 (参阅图19、图21)。

解除电压精度在滞后幅度 = 5.0% ~ 20.0%时为 $\pm 2.5\%$  ( $-V_{DET(S)} = 4.2\text{ V} \sim 4.95\text{ V}$ ) 或 $\pm 3.0\%$  ( $-V_{DET(S)} = 3.0\text{ V} \sim 4.15\text{ V}$ ), 滞后幅度 = 20.0% ~ 30.0%时为 $\pm 3.0\%$  ( $-V_{DET(S)} = 4.2\text{ V} \sim 4.95\text{ V}$ ) 或 $\pm 3.5\%$  ( $-V_{DET(S)} = 3.0\text{ V} \sim 4.15\text{ V}$ )。

在S-19110系列L / M / Q / R型产品中, 解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 与产品的实际检测电压 ( $-V_{DET}$ ) 值相同。

例1 :  $-V_{DET} = 4.0\text{ V}$ 、 $+V_{DET} = 4.4\text{ V}$  产品 (滞后幅度 = 10.0%) 的解除电压为  $4.268\text{ V} \leq +V_{DET} \leq 4.532\text{ V}$  的范围内的一点。  
也就是说, 既有  $+V_{DET} = 4.268\text{ V}$  的产品, 也有  $+V_{DET} = 4.532\text{ V}$  的产品。

例2 :  $-V_{DET} = 4.0\text{ V}$ 、 $+V_{DET} = 5.2\text{ V}$  产品 (滞后幅度 = 30.0%) 的解除电压为  $5.018\text{ V} \leq +V_{DET} \leq 5.382\text{ V}$  的范围内的一点。  
也就是说, 既有  $+V_{DET} = 5.018\text{ V}$  的产品, 也有  $+V_{DET} = 5.382\text{ V}$  的产品。

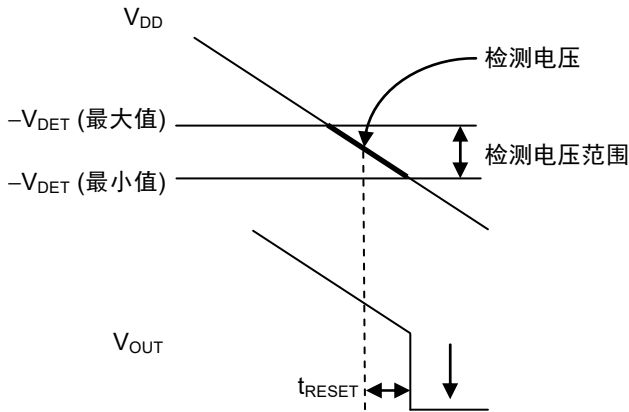


图18 检测电压 (VDD检测产品)

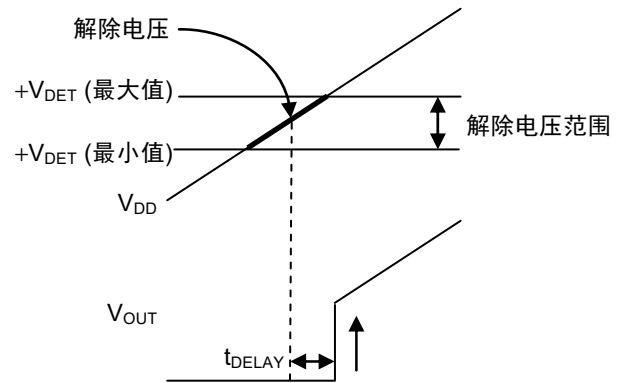


图19 解除电压 (VDD检测产品)

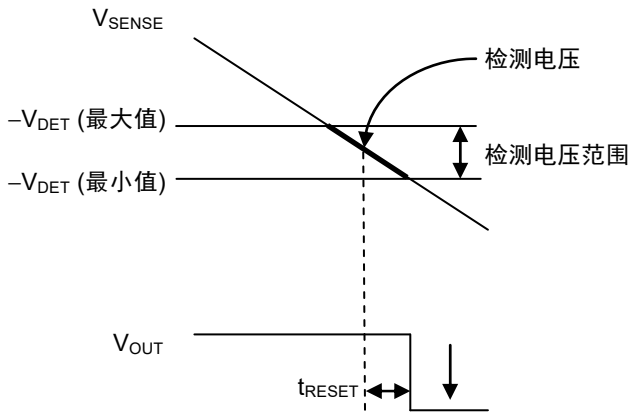


图20 检测电压 (SENSE检测产品)

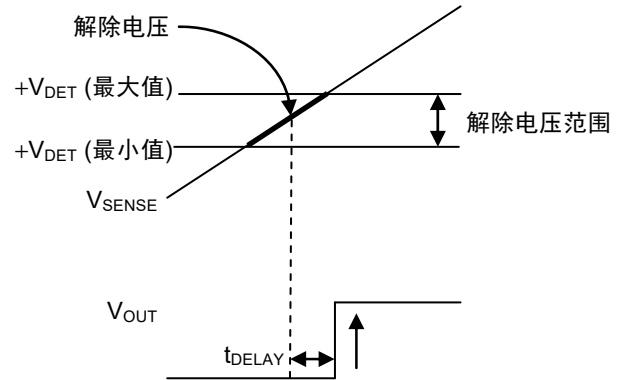


图21 解除电压 (SENSE检测产品)

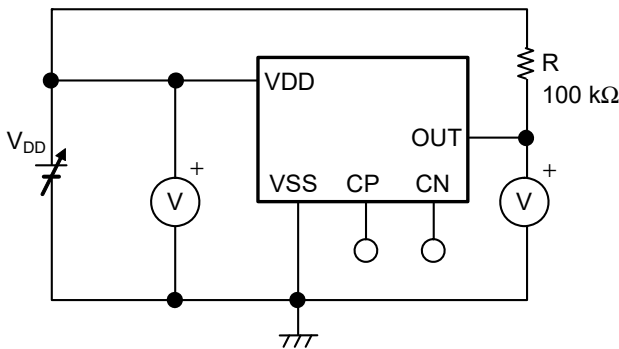


图22 检测电压、解除电压的测定电路 (VDD检测产品)

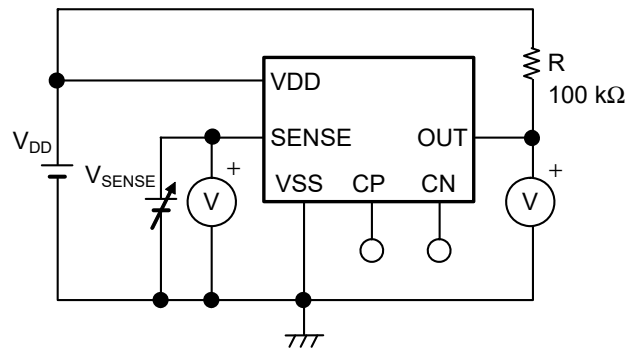


图23 检测电压、解除电压的测定电路 (SENSE检测产品)

### 3. 滞后幅度 (V<sub>HYS</sub>)

滞后幅度表示检测电压与解除电压之间的电压差 (图25、图27、图33、图35中B点的电压 - A点的电压 = V<sub>HYS</sub>)。在检测电压与解除电压之间带有滞后幅度，可以防止在因噪声等侵入输入电压时而产生的误工作。

### 4. 击穿电流

击穿电流是在电压检测器的检测以及解除时瞬间流经VDD端子的电流。

## ■ 工作说明

### 1. 基本工作

#### 1.1 S-19110系列J型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。此时, N沟道晶体管 (N1) 为关状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{DD}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{DD}$ 即使降低到 $+V_{DET}$ 以下, 只要高于检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 就能输出 $V_{DD}$ 。  
 $V_{DD}$ 为 $-V_{DET}$  (图25的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为开, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。此时, N1变为开状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{R_B \cdot V_{DD}}{R_A + R_B}$ 。
- (3)  $V_{DD}$ 进一步下降, 若处在IC的最低工作电压以下输出就会不稳定, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$ 。
- (4) 使 $V_{DD}$ 上升到最低工作电压以上时, 输出 $V_{SS}$ 。另外, 即使 $V_{DD}$ 超过了 $-V_{DET}$ , 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 输出 $V_{SS}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{DD}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图25的B点) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$ 。

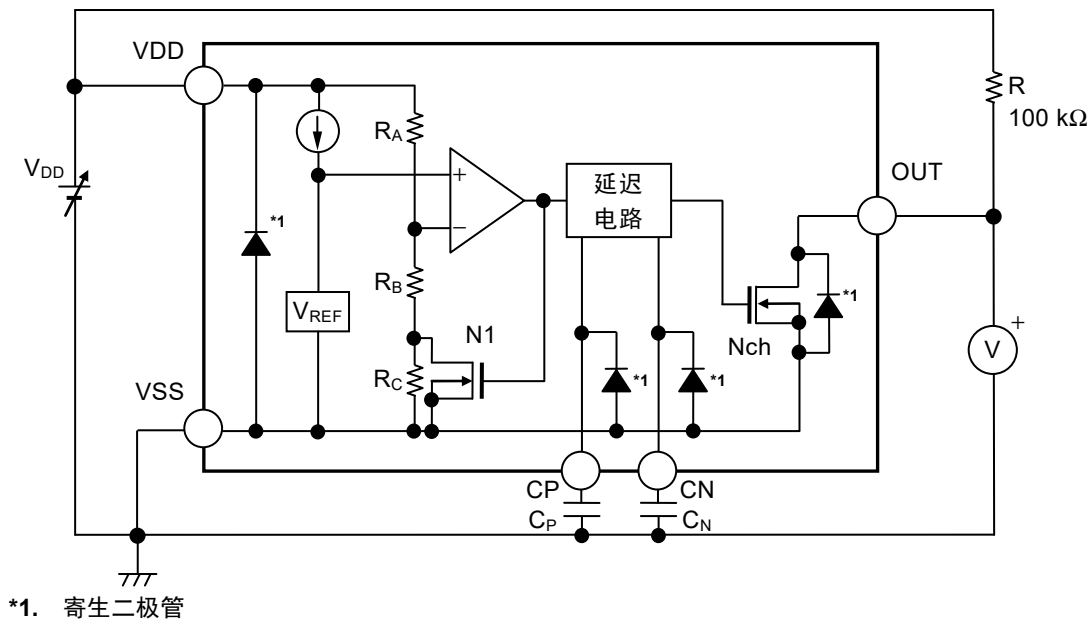
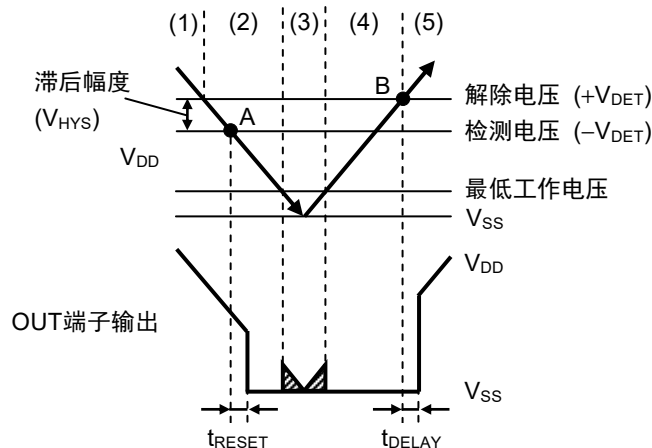


图24 S-19110系列J型的工作说明图

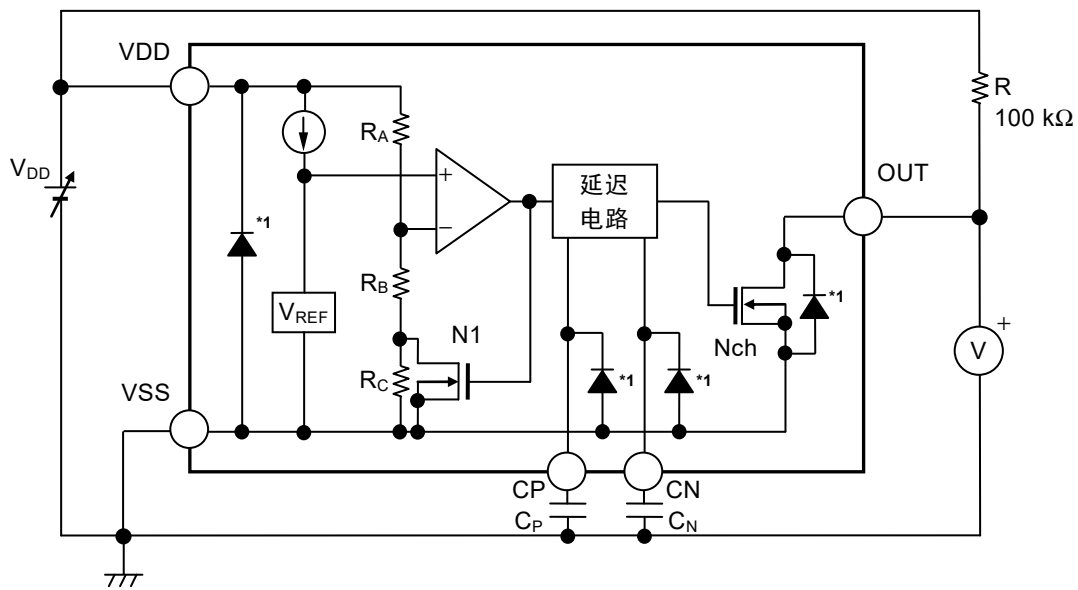


备注  $V_{DD}$ 在最低工作电压以下时, 阴影范围内的OUT端子输出电压不稳定。

图25 S-19110系列J型的时序图

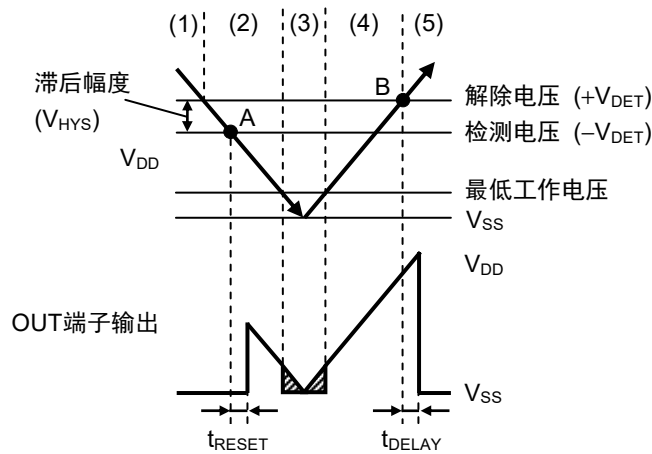
### 1.2 S-19110系列K型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为开, 输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。  
 此时, N沟道晶体管 (N1) 为关状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{DD}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{DD}$ 即使降低到 $+V_{DET}$ 以下, 只要高于检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 就能输出 $V_{SS}$ 。  
 $V_{DD}$ 为 $-V_{DET}$  (图27的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。  
 此时, N1变为开状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{R_B \cdot V_{DD}}{R_A + R_B}$ 。
- (3)  $V_{DD}$ 进一步下降, 若处在IC的最低工作电压以下输出就会不稳定, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$ 。
- (4) 使 $V_{DD}$ 上升到最低工作电压以上时, 输出 $V_{DD}$ 。另外, 即使 $V_{DD}$ 超过了 $-V_{DET}$ , 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 输出 $V_{DD}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{DD}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图27的B点) 以上时, N沟道晶体管变为开, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$ 。



\*1. 寄生二极管

图26 S-19110系列K型的工作说明图



备注  $V_{DD}$ 在最低工作电压以下时, 阴影范围内的OUT端子输出电压不稳定。

图27 S-19110系列K型的时序图

### 1.3 S-19110系列L型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。此时, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{DD}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{DD}$ 为检测电压 ( $-V_{DET}$ ) (图29的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为开, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。
- (3)  $V_{DD}$ 进一步下降, 若处在IC的最低工作电压以下输出就会不稳定, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$ 。
- (4) 使 $V_{DD}$ 上升到最低工作电压以上时, 输出 $V_{SS}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{DD}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图29的B点) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$ 。

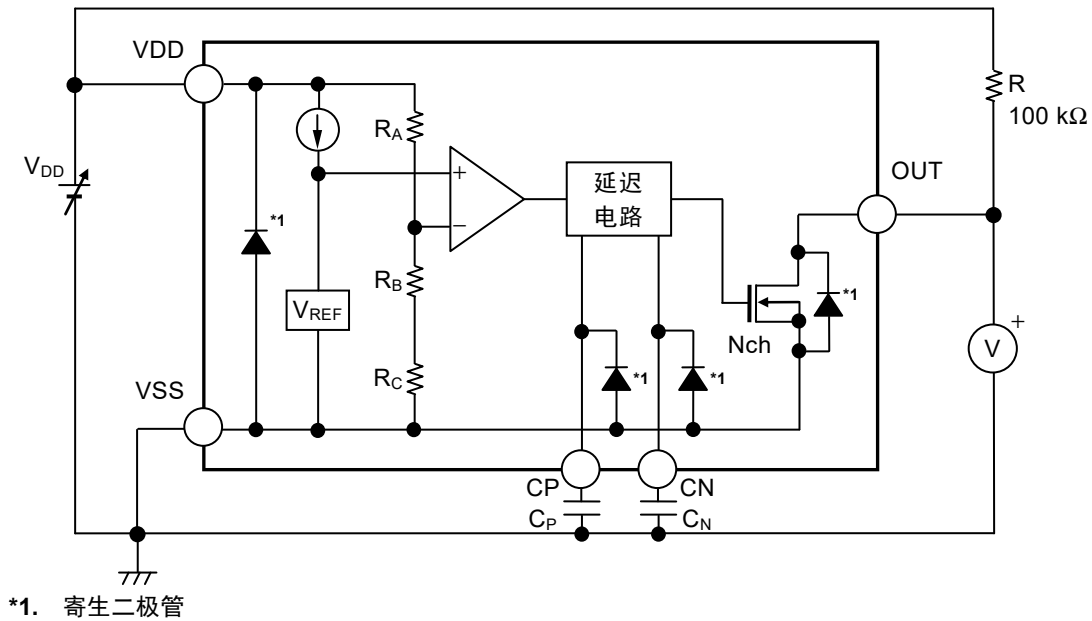
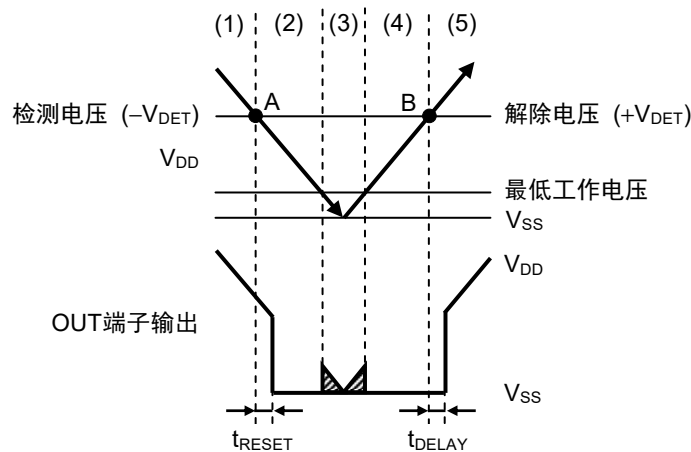


图28 S-19110系列L型的工作说明图



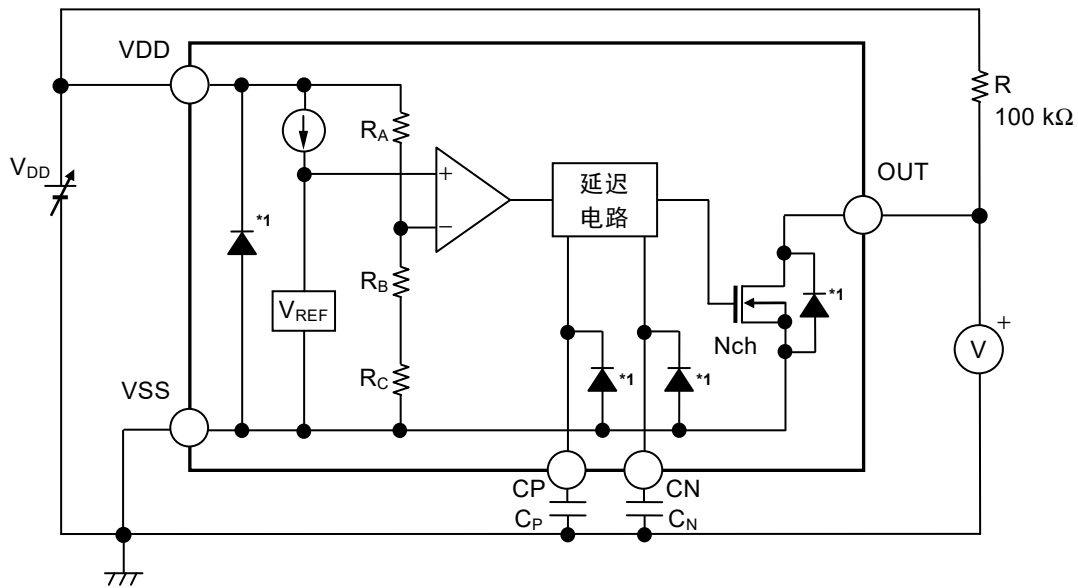
- 备注 1.  $V_{DD}$ 在最低工作电压以下时, 阴影范围内的OUT端子输出电压不稳定。  
2. 因没有滞后幅度, 解除电压被设定为和检测电压值相同。

图29 S-19110系列L型的时序图



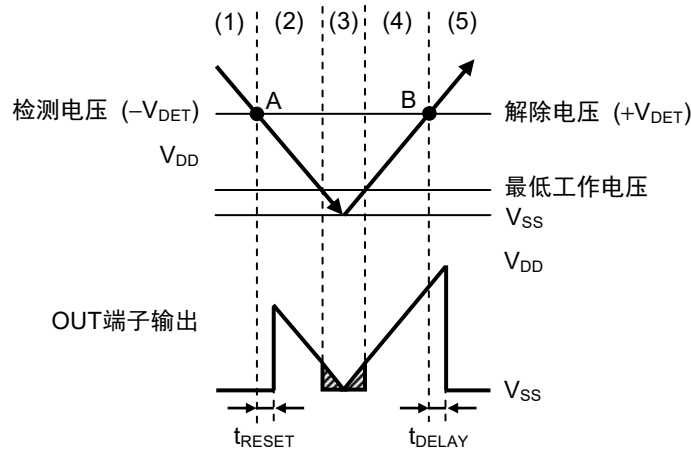
### 1.4 S-19110系列M型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为开, 输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。  
 此时, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{DD}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{DD}$ 为检测电压 ( $-V_{DET}$ ) (图31的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。
- (3)  $V_{DD}$ 进一步下降, 若处在IC的最低工作电压以下输出就会不稳定, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$ 。
- (4) 使 $V_{DD}$ 上升到最低工作电压以上时, 输出 $V_{DD}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{DD}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图31的B点) 以上时, N沟道晶体管变为开, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$ 。



\*1. 寄生二极管

图30 S-19110系列M型的工作说明图



- 备注 1.  $V_{DD}$ 在最低工作电压以下时, 阴影范围内的OUT端子输出电压不稳定。  
 2. 因没有滞后幅度, 解除电压被设定为和检测电压值相同。

图31 S-19110系列M型的时序图

### 1.5 S-19110系列N型

(1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在最低工作电压以上、SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。

此时, N沟道晶体管 (N1) 为关状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B + R_C}$ 。

(2)  $V_{SENSE}$ 即使降低到 $+V_{DET}$ 以下, 只要高于检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 就能输出 $V_{DD}$ 。

$V_{SENSE}$ 为 $-V_{DET}$  (图33的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为开, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。

此时, N1变为开状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{R_B \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B}$ 。

(3)  $V_{SENSE}$ 进一步下降, 但即使降低到IC的最低工作电压以下, 只要 $V_{DD}$ 仍在最低工作电压以上, OUT端子输出就会保持稳定。

(4) 即使 $V_{SENSE}$ 超过了 $-V_{DET}$ , 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 仍会输出 $V_{SS}$ 。

(5) 再继续使 $V_{SENSE}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图33的B点) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$ 。

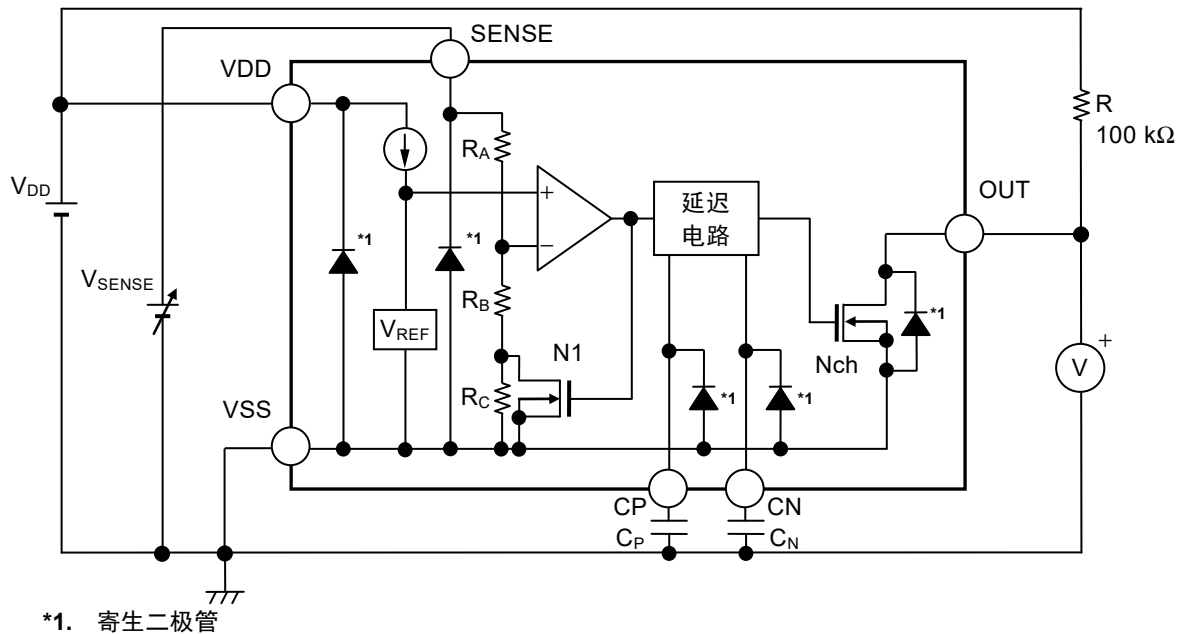


图32 S-19110系列N型的工作说明图

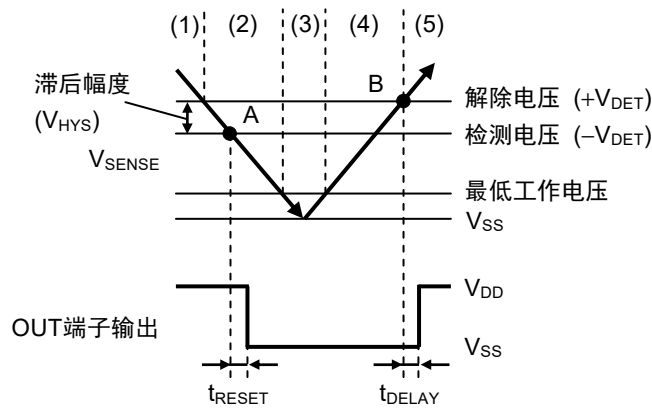


图33 S-19110系列N型的时序图

### 1.6 S-19110系列P型

(1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在最低工作电压以上、SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为开, 输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。

此时, N沟道晶体管 (N1) 为关状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B + R_C}$ 。

(2)  $V_{SENSE}$ 即使降低到 $+V_{DET}$ 以下, 只要高于检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 就能输出 $V_{SS}$ 。

$V_{SENSE}$ 为 $-V_{DET}$  (图35的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。

此时, N1变为开状态, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{R_B \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B}$ 。

(3)  $V_{SENSE}$ 进一步下降, 但即使降低到IC的最低工作电压以下, 只要 $V_{DD}$ 仍在最低工作电压以上, OUT端子输出就会保持稳定。

(4) 即使 $V_{SENSE}$ 超过了 $-V_{DET}$ , 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 仍会输出 $V_{DD}$ 。

(5) 再继续使 $V_{SENSE}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图35的B点) 以上时, N沟道晶体管变为开, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$ 。

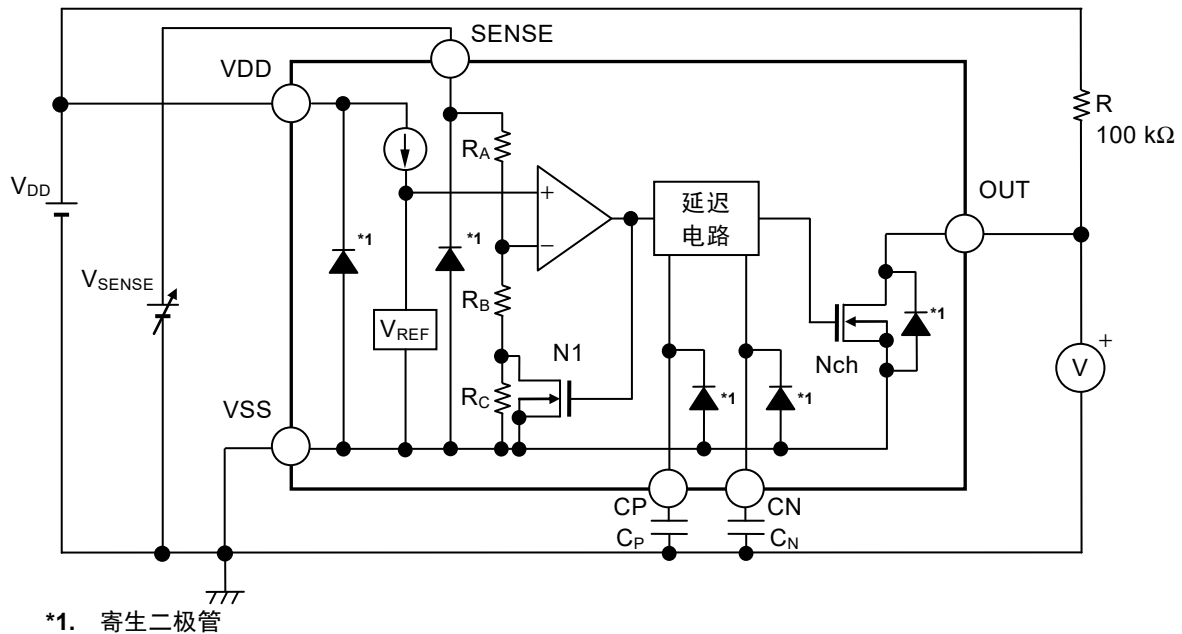


图34 S-19110系列P型的工作说明图

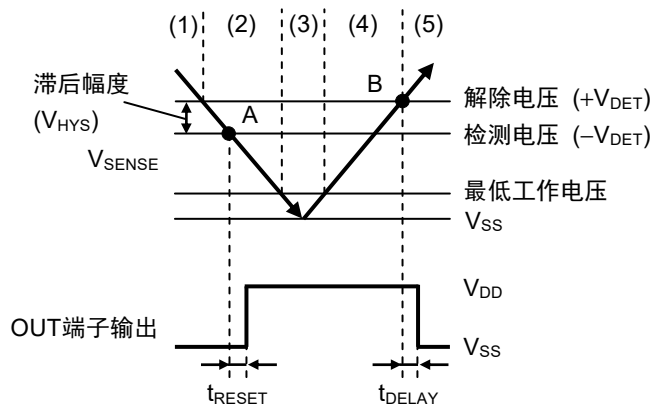


图35 S-19110系列P型的时序图

### 1.7 S-19110系列Q型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在最低工作电压以上、SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。  
此时, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{SENSE}$ 为检测电压 ( $-V_{DET}$ ) (图37的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为开, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。
- (3)  $V_{SENSE}$ 进一步下降, 但即使降低到IC的最低工作电压以下, 只要 $V_{DD}$ 仍在最低工作电压以上, OUT端子输出就会保持稳定。
- (4) 即使 $V_{SENSE}$ 上升, 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 仍会输出 $V_{SS}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{SENSE}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图37的B点) 以上时, N沟道晶体管变为关, 在输出被上拉的情况下, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$ 。

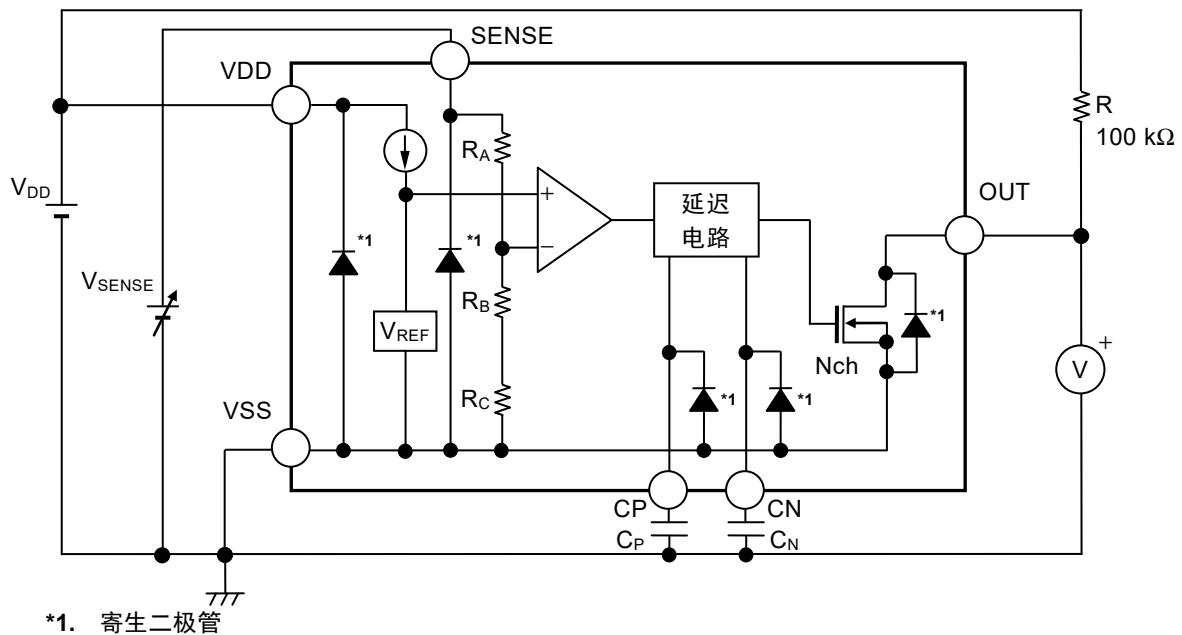
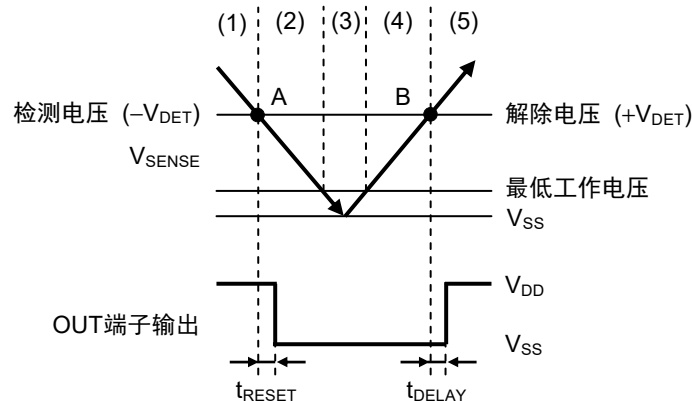


图36 S-19110系列Q型的工作说明图



备注 因没有滞后幅度, 解除电压被设定为和检测电压值相同。

图37 S-19110系列Q型的时序图

### 1.8 S-19110系列R型

- (1) 电源电压 ( $V_{DD}$ ) 在最低工作电压以上、SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ ) 在解除电压 ( $+V_{DET}$ ) 以上时, N沟道晶体管变为开, 输出 $V_{SS}$  (输出 "L")。  
 此时, 向比较器输入的输入电压为  $\frac{(R_B + R_C) \cdot V_{SENSE}}{R_A + R_B + R_C}$ 。
- (2)  $V_{SENSE}$ 为检测电压 ( $-V_{DET}$ ) (图39的A点) 以下时, 输出方的N沟道晶体管变为开, 在输出被上拉的情况下, 经过检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{DD}$  (输出 "H")。
- (3)  $V_{SENSE}$ 进一步下降, 但即使降低到IC的最低工作电压以下, 只要 $V_{DD}$ 仍在最低工作电压以上, OUT端子输出就会保持稳定。
- (4) 即使 $V_{SENSE}$ 上升, 在不足 $+V_{DET}$ 的情况下, 仍会输出 $V_{DD}$ 。
- (5) 再继续使 $V_{SENSE}$ 上升, 上升到 $+V_{DET}$  (图39的B点) 以上时, N沟道晶体管变为开, 经过解除延迟时间 ( $t_{DELAY}$ ) 后, 从OUT端子输出 $V_{SS}$ 。

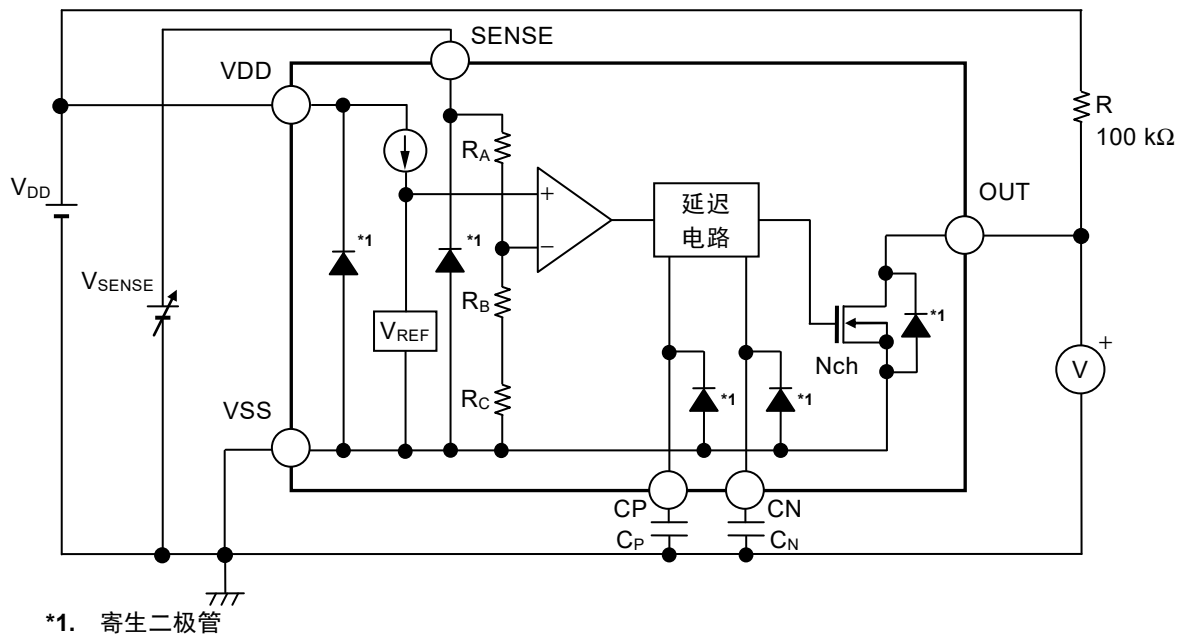
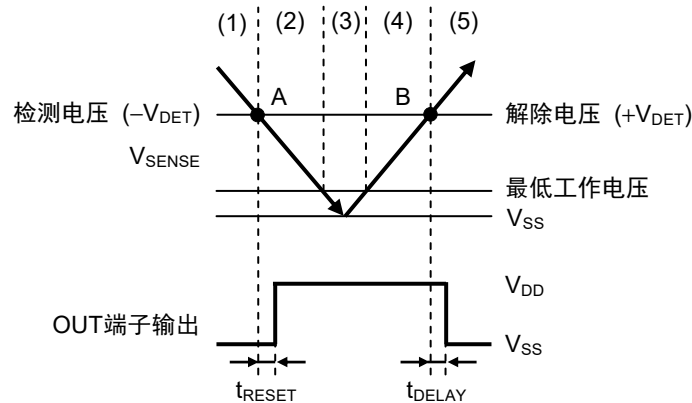


图38 S-19110系列R型的工作说明图



备注 因没有滞后幅度, 解除电压被设定为和检测电压值相同。

图39 S-19110系列R型的时序图

## 2. 延迟电路

延迟电路备有调整从电源电压 (V<sub>DD</sub>) 或SENSE端子电压 (V<sub>SENSE</sub>) 到达检测电压 (-V<sub>DET</sub>) 以下开始到OUT端子输出反转为止的检测延迟时间 (t<sub>RESET</sub>) 的功能。

延迟电路备有调整从电源电压 (V<sub>DD</sub>) 或SENSE端子电压 (V<sub>SENSE</sub>) 到达解除电压 (+V<sub>DET</sub>) 开始到OUT端子输出反转为止的解除延迟时间(t<sub>DELAY</sub>) 的功能。

t<sub>RESET</sub>是由延迟系数、延迟用电容器 (C<sub>N</sub>) 及CN端子处于开路状态时的检测延迟时间 (t<sub>RESET0</sub>) 而决定, t<sub>DELAY</sub>是由延迟系数、延迟用电容器 (C<sub>P</sub>) 及CP端子处于开路状态时的解除延迟时间 (t<sub>DELAY0</sub>) 而决定, 按如下公式计算出来。

$$t_{RESET} [\text{ms}] = \text{延迟系数} \times C_N [\text{nF}] + t_{RESET0} [\text{ms}]$$

$$t_{DELAY} [\text{ms}] = \text{延迟系数} \times C_P [\text{nF}] + t_{DELAY0} [\text{ms}]$$

表9

工作温度	延迟系数		
	最小值	典型值	最大值
Ta = +125°C	2.41	2.85	3.32
Ta = +105°C	2.41	2.85	3.32
Ta = +25°C	2.41	2.86	3.30
Ta = -40°C	2.40	2.83	3.25

表10

工作温度	CN端子处于开路状态时的 检测延迟时间 (t <sub>RESET0</sub> )	CP端子处于开路状态时的 解除延迟时间 (t <sub>DELAY0</sub> )
	典型值	典型值
Ta = -40°C ~ +125°C	0.35 ms	0.35 ms

- 注意 1. 因为CN端子、CP端子的阻抗很高, 在安装基板布局时请注意不要从外部向此端子流入电流, 或者流出电流 (有可能无法得到正确的延迟时间)。
2. 只要选择相对内置恒流电流值 (约300 nA) 可以忽视电容器本身的泄漏电流的产品, C<sub>N</sub>、C<sub>P</sub>的电容就不受限制。若有泄漏电流, 延迟时间就会与产生误差。另外, 若有内置恒流电流以上的泄漏电流就不能进行检测和解除。
3. 以上公式并不能保证工作。C<sub>N</sub>、C<sub>P</sub>的电容须在实际的使用条件下对温度特性等进行充分评估之后再决定。有关使用相当于X8R的电容器时的特性, 请参照 "■ 参考数据" 的 "2. 检测延迟时间 (t<sub>RESET</sub>) - 温度 (Ta)"、"3. 检测延迟时间 (t<sub>RESET</sub>) - 电源电压 (V<sub>DD</sub>)"、"5. 解除延迟时间 (t<sub>DELAY</sub>) - 温度 (Ta)"、"6. 解除延迟时间 (t<sub>DELAY</sub>) - 电源电压 (V<sub>DD</sub>)"。

## ■ 使用时的注意事项

### 1. 检测、解除时的击穿电流

S-19110系列在检测及解除时会有击穿电流流动。因此，如果增高输入阻抗，则可能因击穿电流而引起电压下降从而发生振荡。

按图40、图41的构成使用S-19110系列时，建议输入阻抗控制在1 kΩ以下。  
在实际的使用条件下，请对温度特性等进行充分的评估之后再决定。

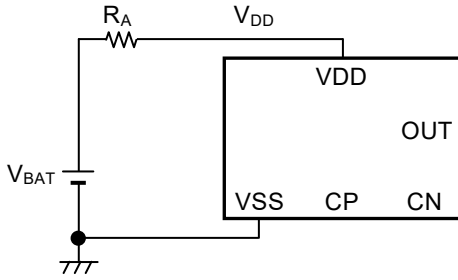


图40 VDD检测产品

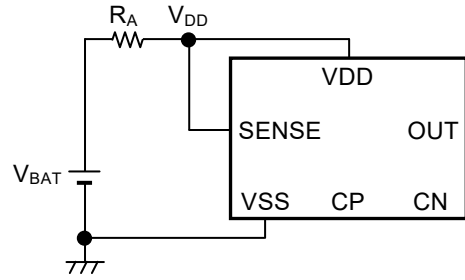


图41 SENSE检测产品

## 2. 接通、关闭电源的顺序

SENSE检测产品在由VDD端子供电的状态下监视SENSE端子电压 ( $V_{SENSE}$ )。

请按VDD端子、SENSE端子的顺序接通电源。

另外，在关闭VDD端子时先关闭SENSE端子，在检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) 经过后再关闭VDD端子。

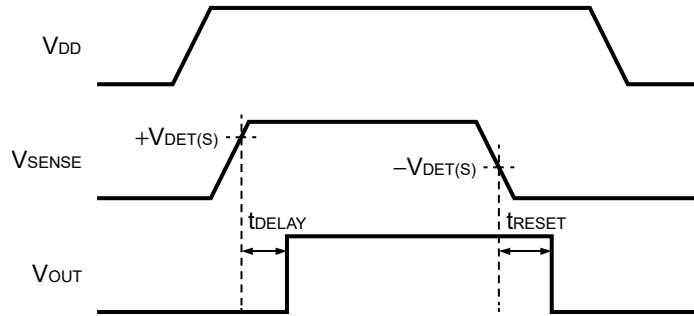


图42

## 3. 电源下降 (参考)

在解除状态下将VDD端子 (VDD检测产品) 陡然降低到检测电压 ( $-V_{DET}$ ) 以上的电压时,可保持解除状态的VDD振幅量 ( $V_{P-P}$ ) 和输入电压下降时间 ( $t_F$ ) 的关系如图43所示。

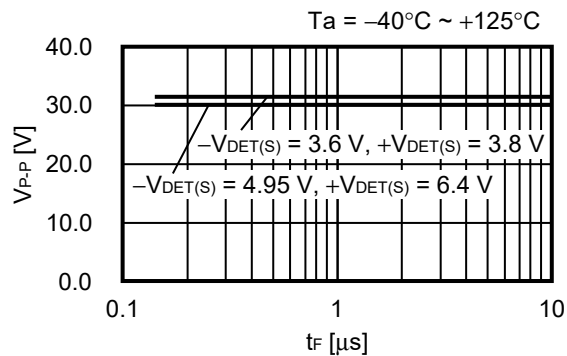
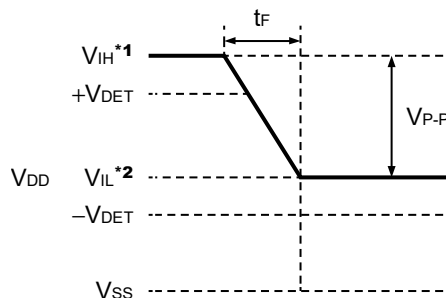


图43



\*1.  $V_{IH} = 36.0 \text{ V}$

\*2.  $V_{IL} = -V_{DET(S)} + 1.0 \text{ V}$

图44 VDD端子输入电压波形

**注意** 图43表示可保持解除状态的输入电压条件。如果将与上述条件相比 $V_{P-P}$ 及 $t_F$ 更大的电压输入到VDD端子 (VDD检测产品), OUT端子可能会进入检测状态。



#### 4. VDD端子、SENSE端子电压的电子脉冲 (参考)

##### 4.1 检测工作

在解除状态下将检测电压 ( $-V_{DET}$ ) 以下的脉冲输入到VDD端子 (VDD检测产品) 或SENSE端子 (SENSE检测产品) 时, 可保持解除状态的脉冲幅度和脉冲电压差 ( $V_{OD}$ ) 的关系如图45、图46所示。

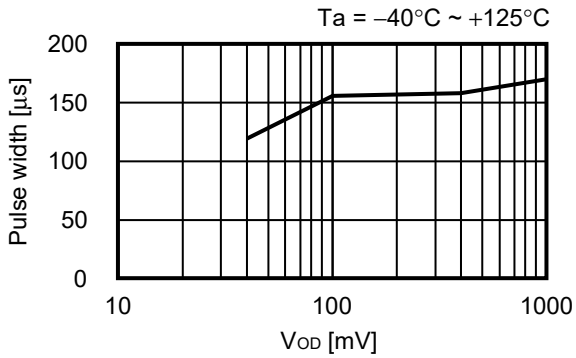


图45 VDD检测产品

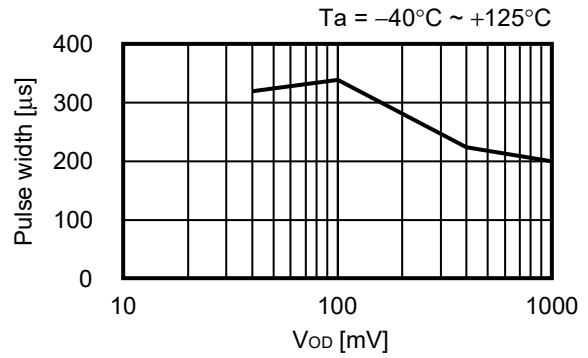
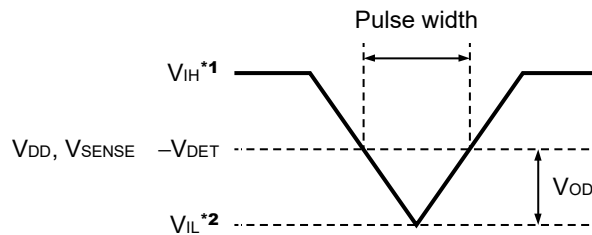


图46 SENSE检测产品



\*1.  $V_{IH} = 16.0 \text{ V}$

\*2.  $V_{IL} = -V_{DET} - V_{OD}$

图47 VDD端子、SENSE端子输入电压波形

**注意** 图45、图46表示可保持解除状态的脉冲条件。如果将与上述条件相比脉冲幅度及 $V_{OD}$ 更大的脉冲输入到VDD端子 (VDD检测产品) 或SENSE端子 (SENSE检测产品), OUT端子可能会进入检测状态。

#### 4.2 解除工作

在检测状态下将解除电压 (+V<sub>DET</sub>) 以上的脉冲输入到VDD端子 (VDD检测产品) 或SENSE端子 (SENSE检测产品) 时, 可保持检测状态的脉冲幅度和脉冲电压差 (V<sub>OD</sub>) 的关系如图48、图49所示。

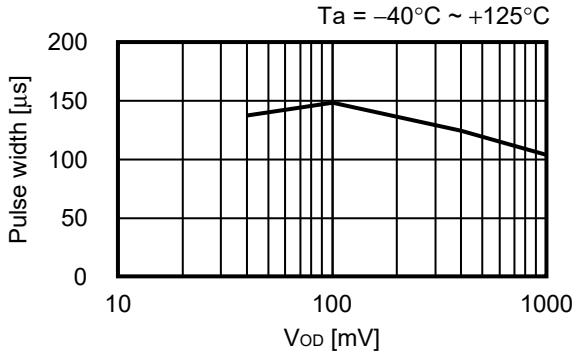


图48 VDD检测产品

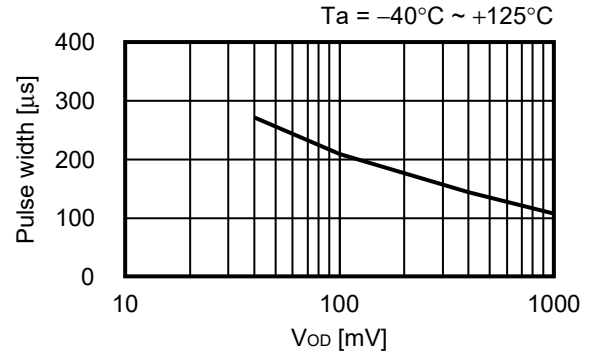
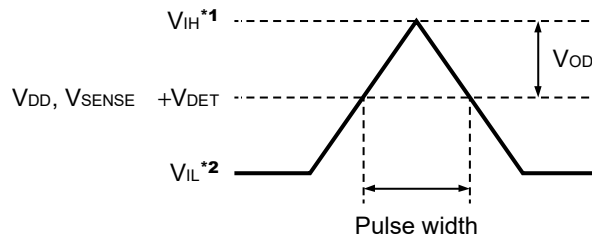


图49 SENSE检测产品



- \*1.  $V_{IH} = +V_{DET} + V_{OD}$
- \*2.  $V_{IL} = +V_{DET} - 1.0\text{ V}$

图50 VDD端子、SENSE端子输入电压波形

**注意** 图48、图49表示可保持检测状态的脉冲条件。如果将与上述条件相比脉冲幅度及V<sub>OD</sub>更大的脉冲输入到VDD端子 (VDD检测产品) 或SENSE端子 (SENSE检测产品), OUT端子可能会进入解除状态。

### 5. 检测延迟时间精度 (参考)

陡然降低VDD端子 (VDD检测产品) 时, 可保持任意设定的检测延迟时间精度的VDD振幅量 ( $V_{P-P}$ ) 和输入电压下降时间 ( $t_F$ ) 的关系如图51、图52所示。

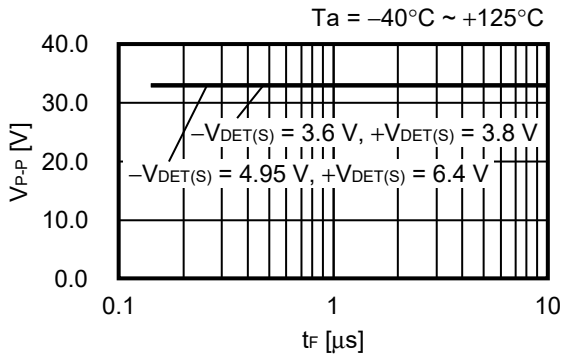


图51  $C_N = 3.3 \text{ nF}$

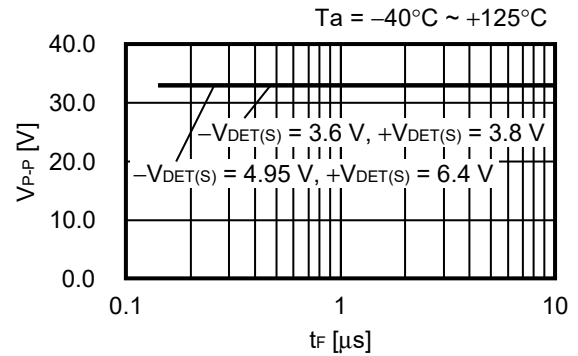
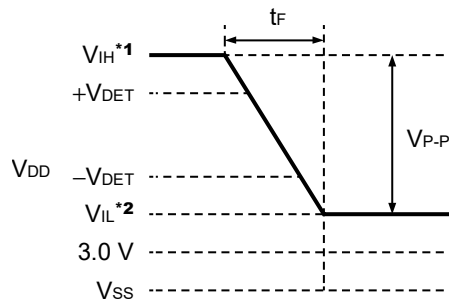


图52  $C_N = 100 \text{ nF}$



- \*1.  $V_{IH} = 36.0 \text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = -V_{DET(S)} - 1.0 \text{ V}$  ( $-V_{DET(S)} \geq 4.0 \text{ V}$ )  
 $V_{IL} = 3.0 \text{ V}$  ( $-V_{DET(S)} < 4.0 \text{ V}$ )

图53 VDD端子输入电压波形

**注意** 图51、图52表示可保持检测延迟时间精度的输入电压的条件。如果将与上述条件相比 $V_{P-P}$ 及 $t_F$ 更大的电压输入到VDD端子 (VDD检测产品), 则可能无法获得所需的检测延迟时间。

### 6. 解除延迟时间中的V<sub>DD</sub>下降 (参考)

解除延迟时间中,V<sub>DD</sub>端子 (V<sub>DD</sub>检测产品) 瞬间下降到检测电压 (-V<sub>DET</sub>) 以下,然后再次上升到解除电压 (+V<sub>DET</sub>) 以上时,在经过正常的解除延迟时间后输出解除信号的脉冲幅度 (t<sub>PW</sub>) 与V<sub>DD</sub>下限值 (V<sub>DROP</sub>) 之间的关系如图54、图55所示。

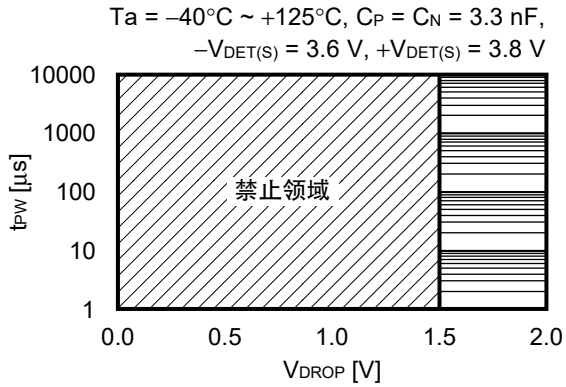


图54

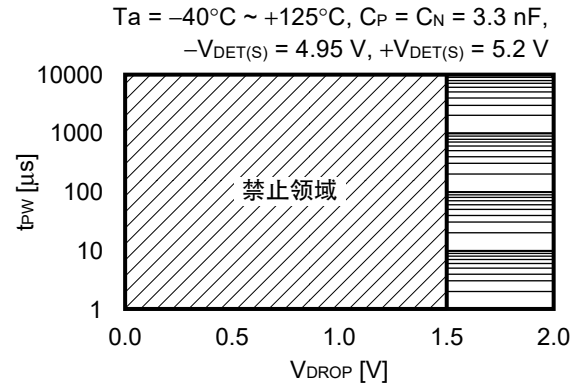


图55

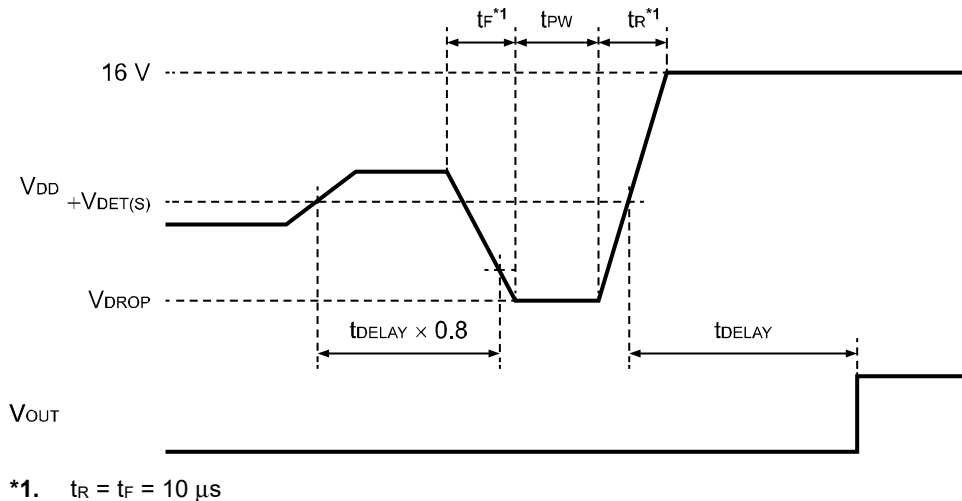


图56 V<sub>DD</sub>端子输入电压波形

- 注意 1. 图54、图55表示正常的解除延迟时间经过后输出解除信号的输入电压条件。变为禁止领域后,在延迟时间结束前可能会被误解除。
2. 解除延迟时间中V<sub>DD</sub>端子电压变为如图54、图55所示的禁止领域时,请先向V<sub>DD</sub>端子输入0 V,然后再次启动S-19110系列。

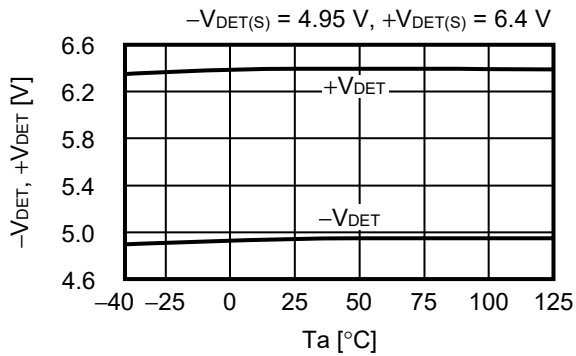
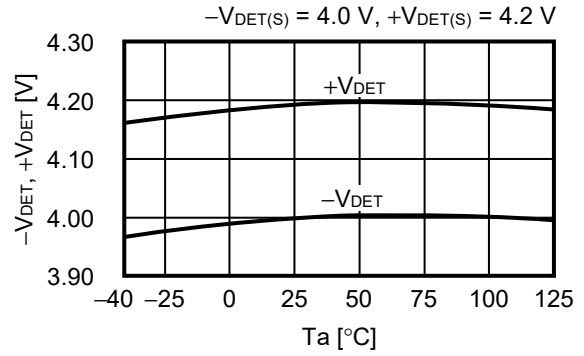
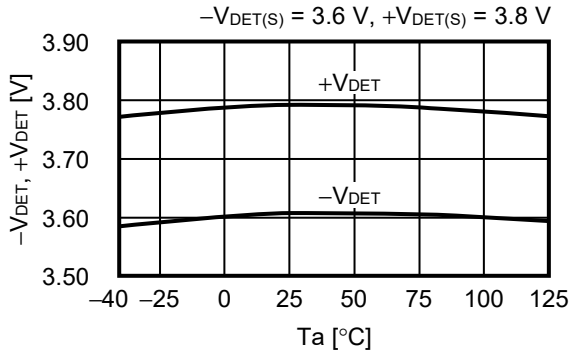
## ■ 注意事项

- 本IC虽内置了防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- SENSE端子因电阻较高，因此可能会因噪音而发生误工作。  
在实际的应用电路中，请注意与SENSE端子的布线并行的布线。
- 本资料中所记载的应用电路用于大量生产设计的情况下，请注意部件的偏差与温度特性。另外，有关所记载电路的专利，本公司概不承担相应责任。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格、或因进口国等原因，使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。

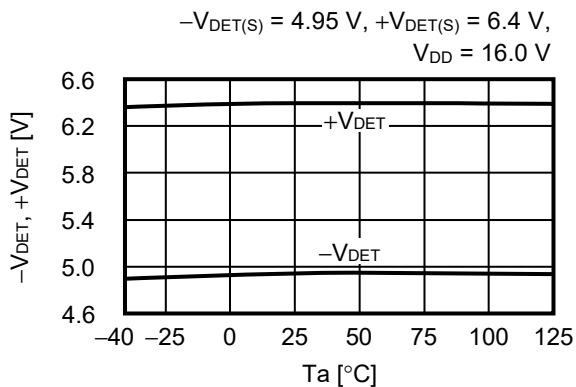
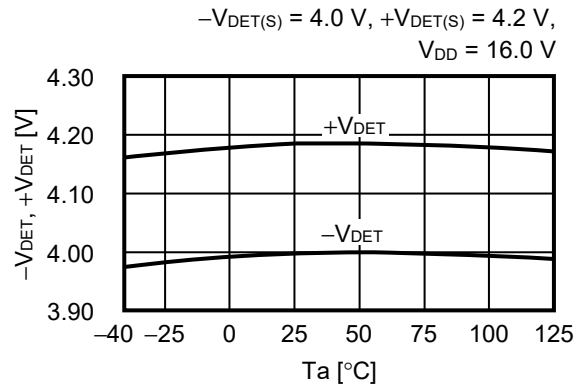
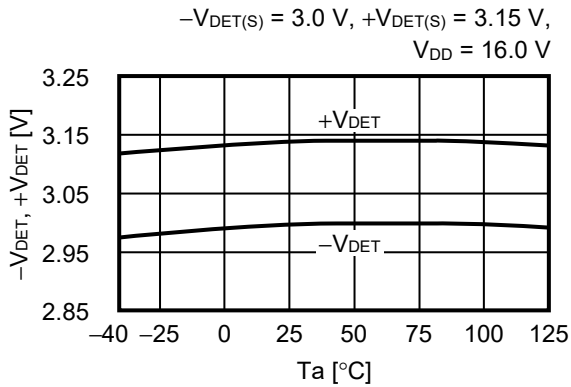
■ 各种特性数据 (典型数据)

1. 检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 解除电压 ( $+V_{DET}$ ) - 温度 ( $T_a$ )

1.1 VDD检测产品

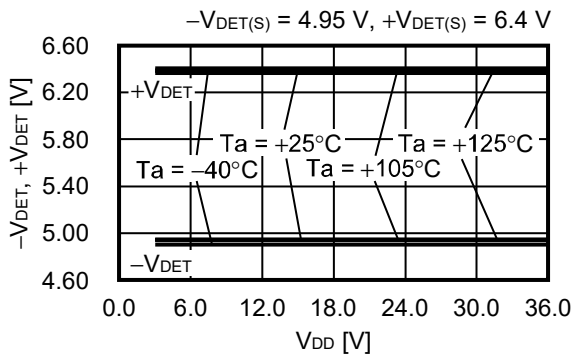
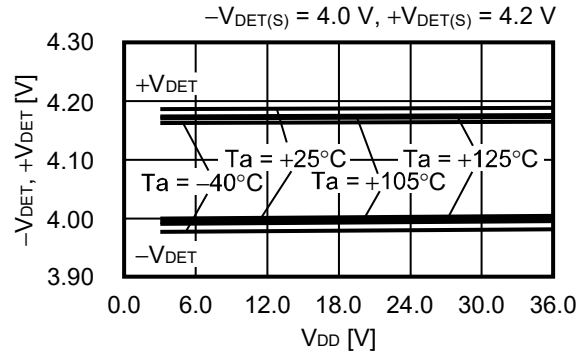
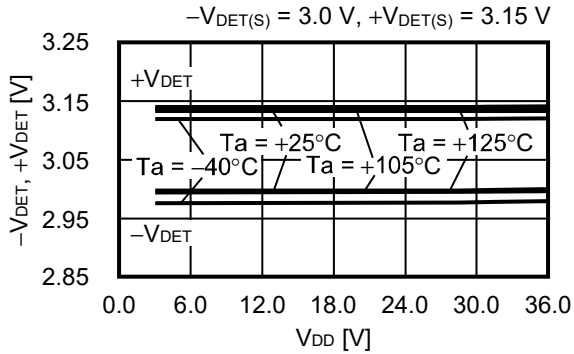


1.2 SENSE检测产品



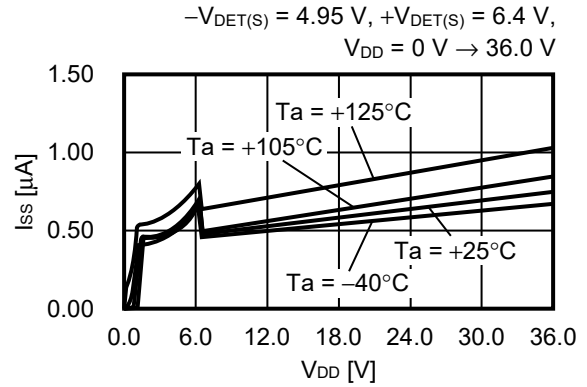
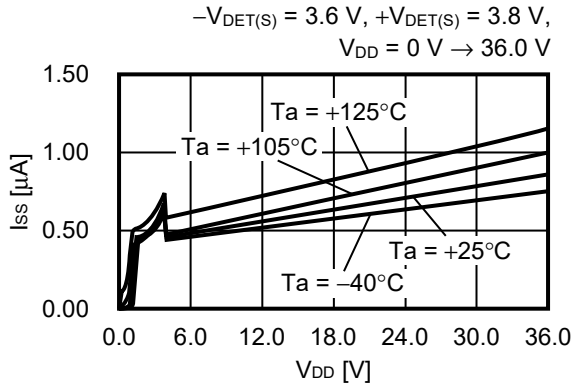
2. 检测电压 ( $-V_{DET}$ ), 解除电压 ( $+V_{DET}$ ) - 电源电压 ( $V_{DD}$ )

2.1 SENSE检测产品

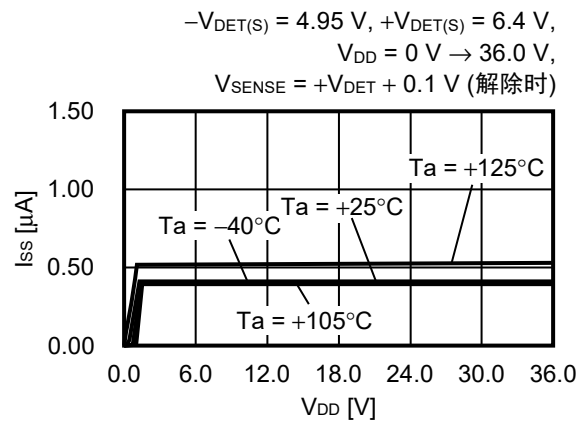
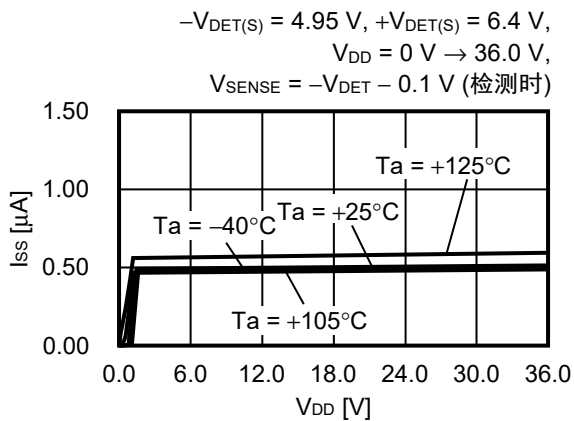
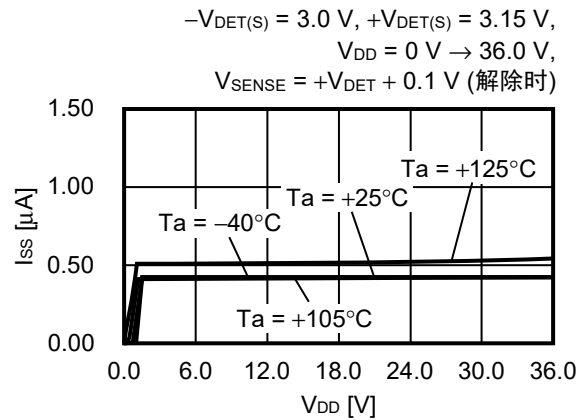
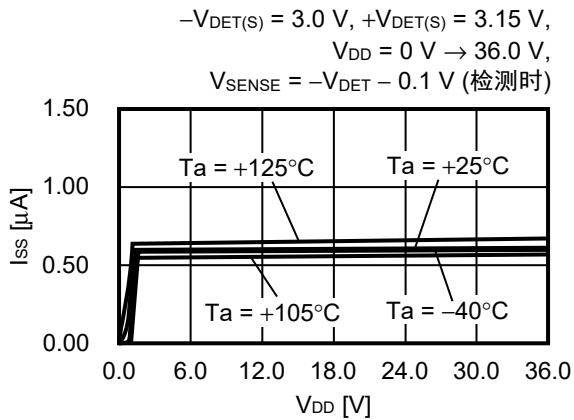


### 3. 消耗电流 (I<sub>SS</sub>) – 电源电压 (V<sub>DD</sub>)

#### 3.1 VDD检测产品



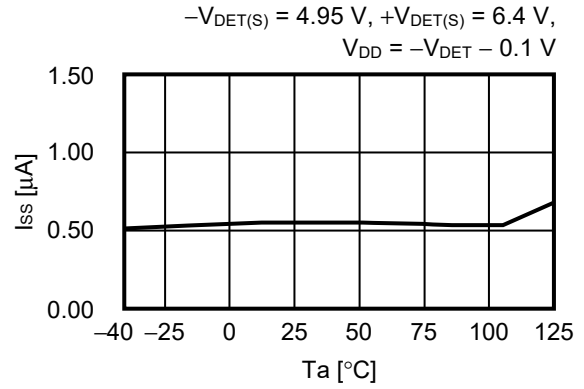
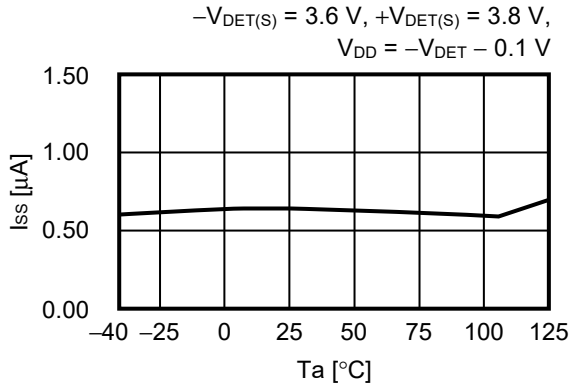
#### 3.2 SENSE检测产品



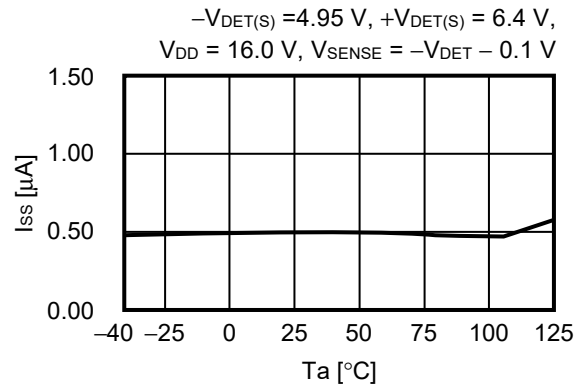
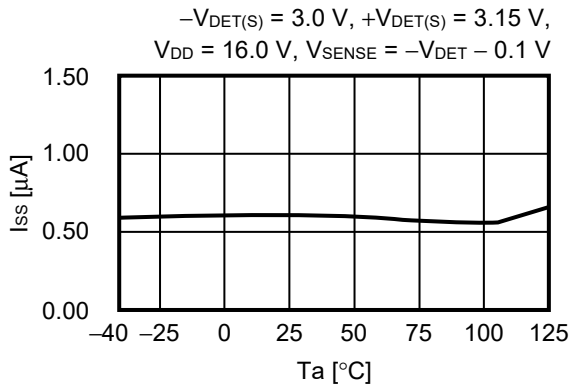


#### 4. 消耗电流 (I<sub>SS</sub>) – 温度 (Ta)

##### 4.1 VDD检测产品

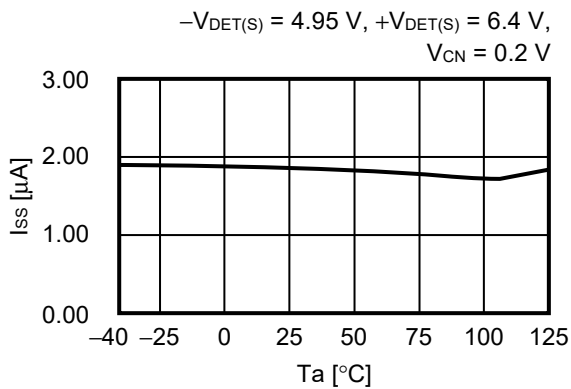


##### 4.2 SENSE检测产品

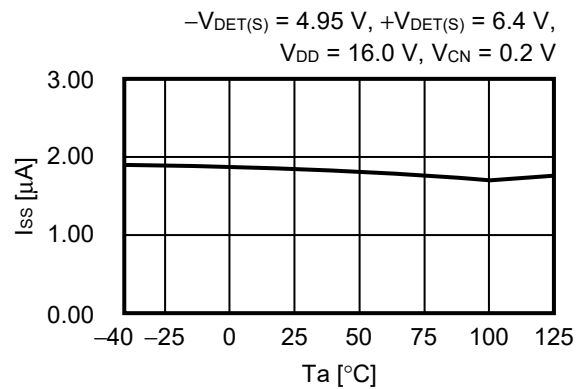


#### 5. 检测延迟时消耗电流 (I<sub>SS</sub>) – 温度 (Ta)

##### 5.1 VDD检测产品



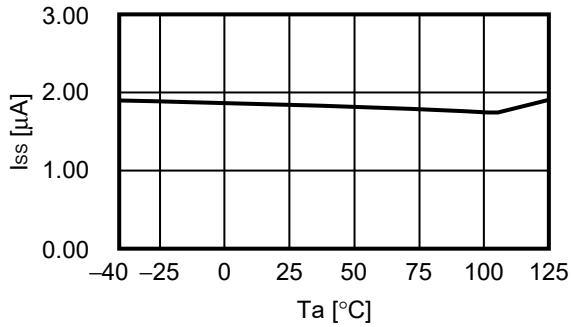
##### 5.2 SENSE检测产品



## 6. 解除延迟时消耗电流 ( $I_{SS}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

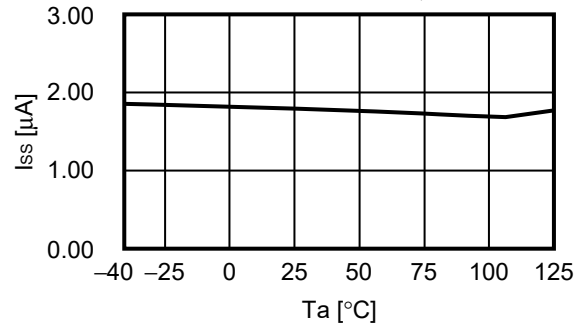
### 6.1 VDD检测产品

$$-V_{DET(S)} = 4.95 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 6.4 \text{ V}, \\ V_{CP} = 0.2 \text{ V}$$



### 6.2 SENSE检测产品

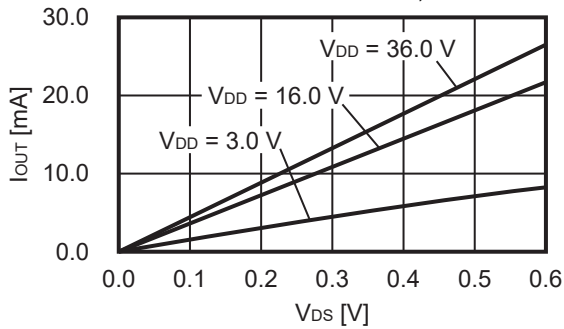
$$-V_{DET(S)} = 4.95 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 6.4 \text{ V}, \\ V_{DD} = 16.0 \text{ V}, V_{CP} = 0.2 \text{ V}$$



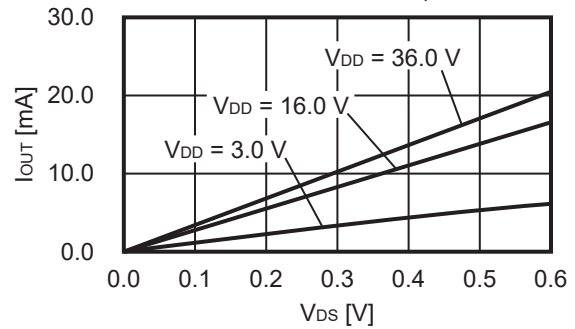
## 7. N沟道晶体管输出电流 ( $I_{OUT}$ ) – $V_{DS}$

### 7.1 SENSE检测产品

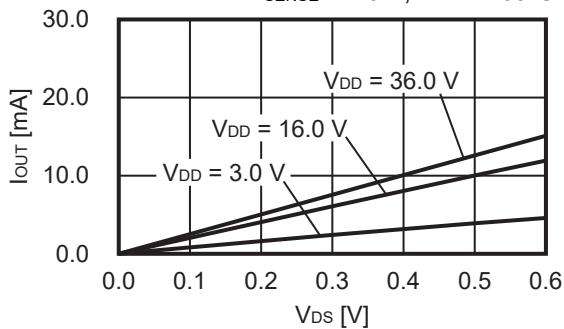
$$-V_{DET(S)} = 4.0 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V}, \\ V_{SENSE} = 2.9 \text{ V}, T_a = -40^\circ\text{C}$$



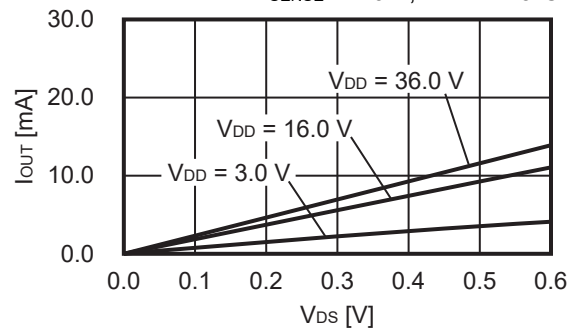
$$-V_{DET(S)} = 4.0 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V}, \\ V_{SENSE} = 2.9 \text{ V}, T_a = +25^\circ\text{C}$$



$$-V_{DET(S)} = 4.0 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V}, \\ V_{SENSE} = 2.9 \text{ V}, T_a = +105^\circ\text{C}$$



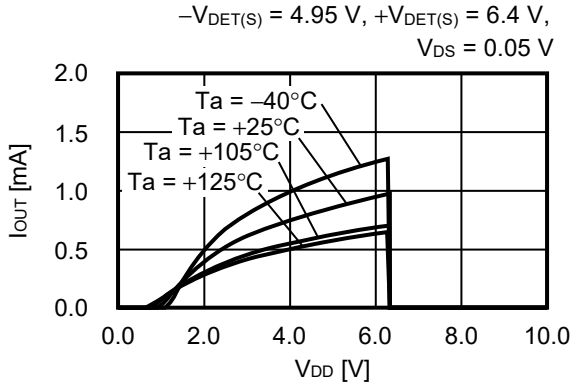
$$-V_{DET(S)} = 4.0 \text{ V}, +V_{DET(S)} = 4.2 \text{ V}, \\ V_{SENSE} = 2.9 \text{ V}, T_a = +125^\circ\text{C}$$



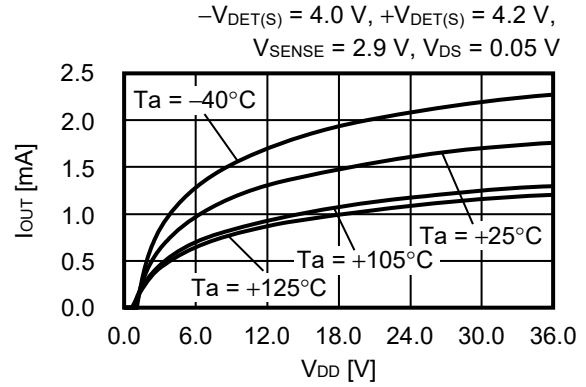
备注  $V_{DS}$ : 输出晶体管的漏极、源极间电压。

## 8. N沟道晶体管输出电流 ( $I_{OUT}$ ) – 电源电压 ( $V_{DD}$ )

### 8.1 VDD检测产品

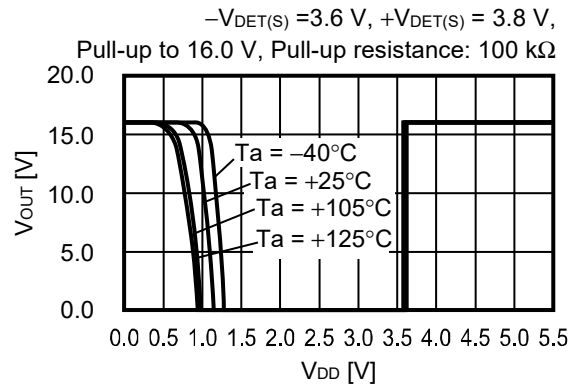
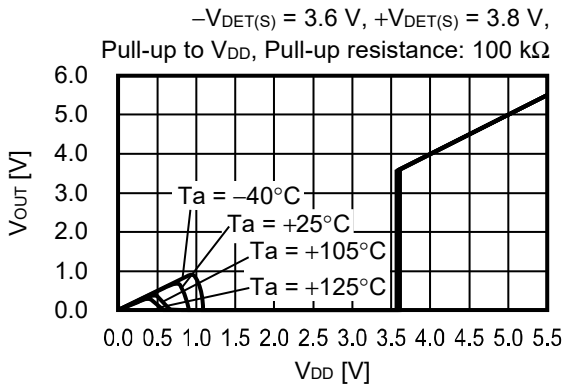


### 8.2 SENSE检测产品

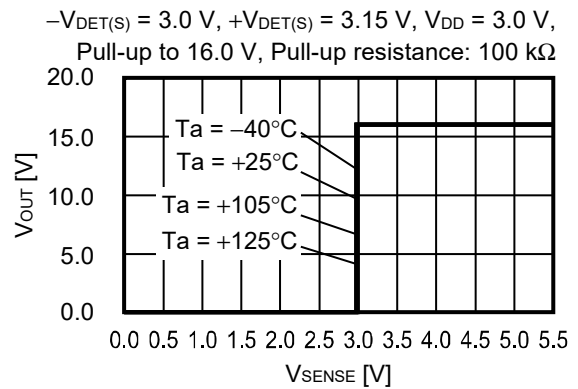
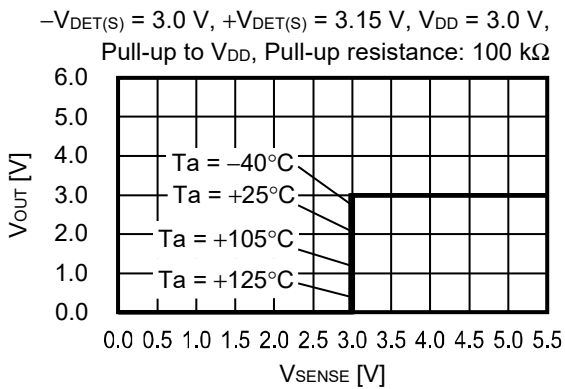


## 9. 最低工作电压 ( $V_{OUT}$ ) – 电源电压 ( $V_{DD}$ )

### 9.1 VDD检测产品



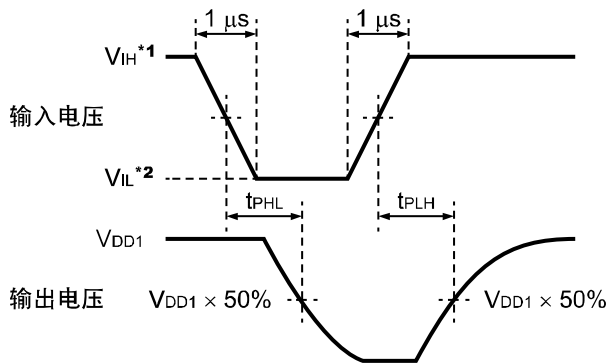
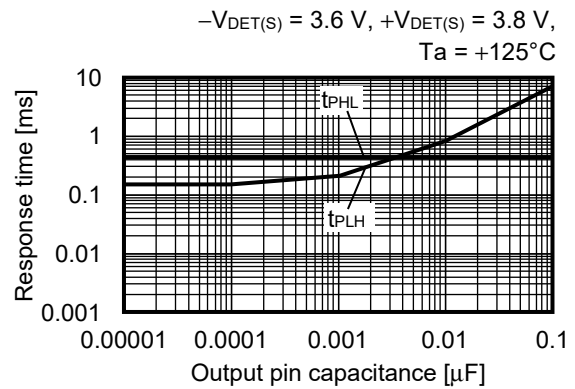
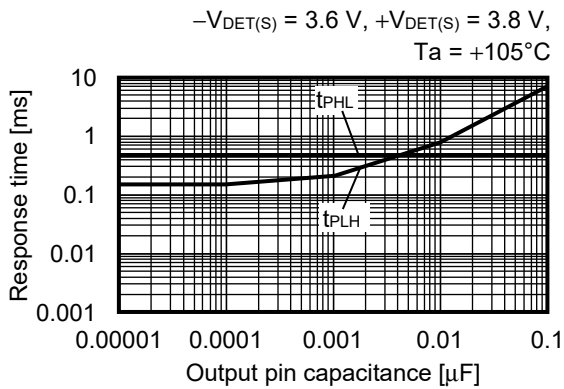
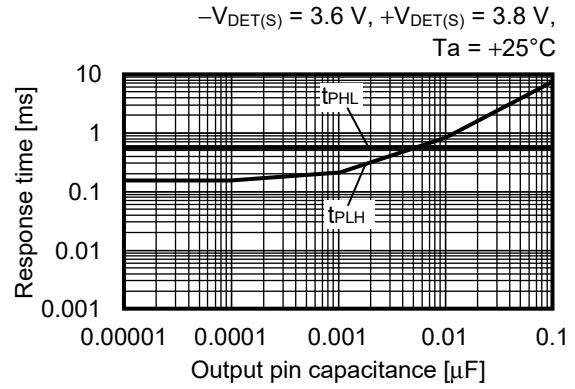
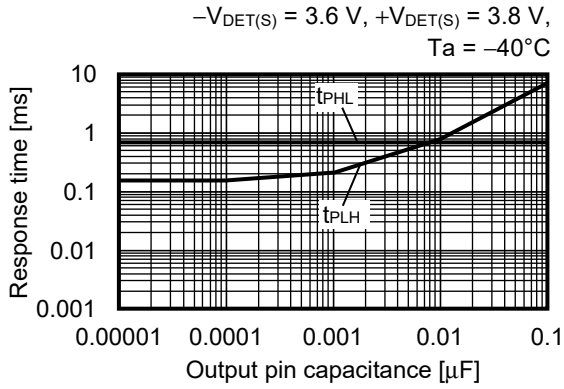
### 9.2 SENSE检测产品



备注  $V_{DS}$ : 输出晶体管的漏极、源极间电压。

10. 动态响应特性 – 输出端子电容 (C<sub>OUT</sub>) (CP端子、CN端子为开路状态)

10.1 VDD检测产品



- \*1.  $V_{IH} = 36.0\text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = 3.0\text{ V}$

图57 响应时间的测定条件

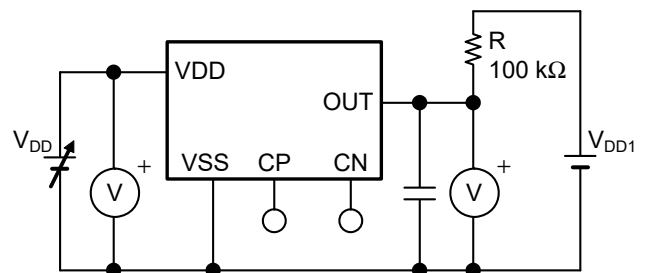


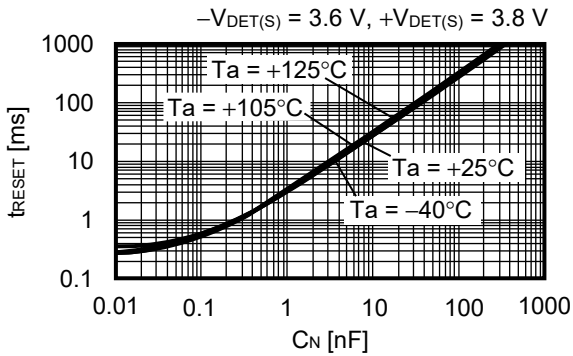
图58 响应时间的测定电路

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

■ 参考数据

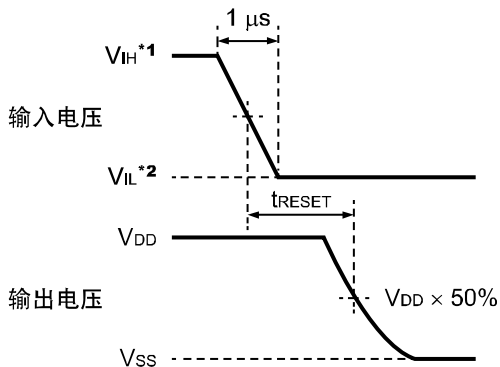
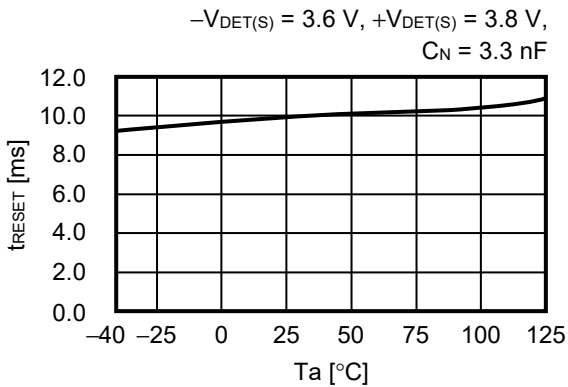
1. 检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) – CN端子电容 ( $C_N$ ) (无输出端子电容)

1.1 VDD检测产品



2. 检测延迟时间 ( $t_{RESET}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

2.1 VDD检测产品



- \*1.  $V_{IH} = -V_{DET(S)} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{IL} = -V_{DET(S)} - 0.5\text{ V}$

图59 检测延迟时间的测定条件

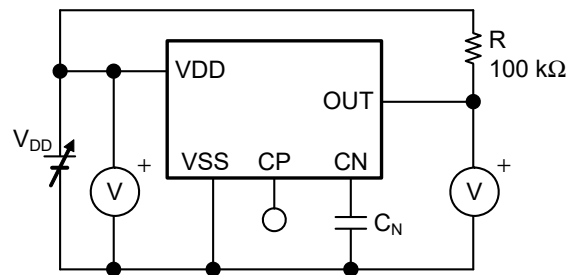
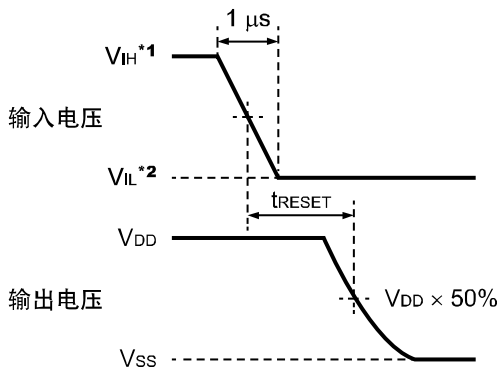
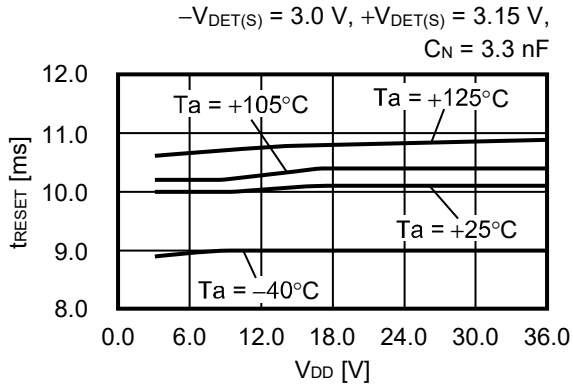


图60 检测延迟时间的测定电路

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

### 3. 检测延迟时间 ( $t_{\text{RESET}}$ ) – 电源电压 ( $V_{\text{DD}}$ )

#### 3.1 SENSE检测产品



- \*1.  $V_{\text{IH}} = -V_{\text{DET(S)}} + 0.5 \text{ V}$
- \*2.  $V_{\text{IL}} = -V_{\text{DET(S)}} - 0.5 \text{ V}$

图61 检测延迟时间的测定条件

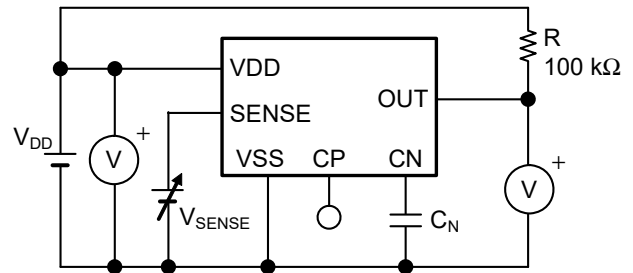
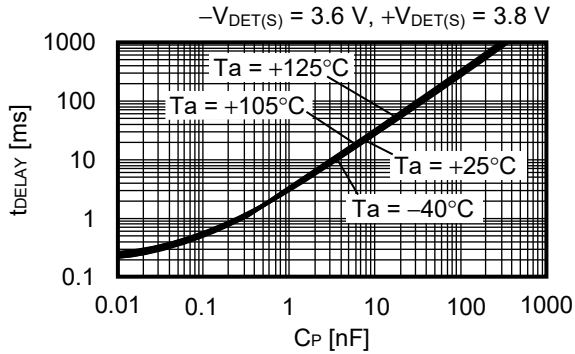


图62 检测延迟时间的测定电路

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

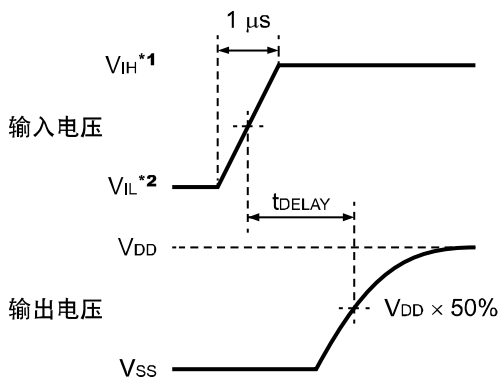
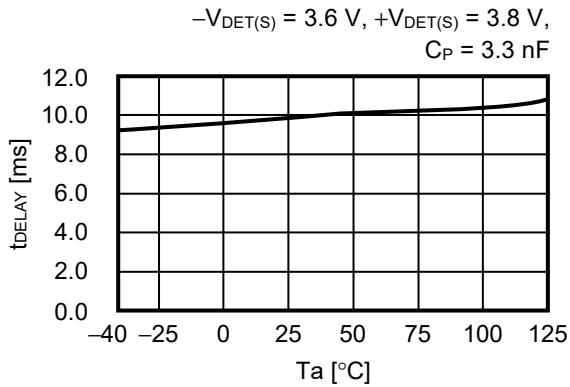
4. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – CP端子电容 ( $C_P$ ) (无输出端子电容)

4.1 VDD检测产品



5. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

5.1 VDD检测产品



- \*1.  $V_{\text{IH}} = +V_{\text{DET(S)}} + 0.5\text{ V}$
- \*2.  $V_{\text{IL}} = +V_{\text{DET(S)}} - 0.5\text{ V}$

图63 解除延迟时间的测定条件

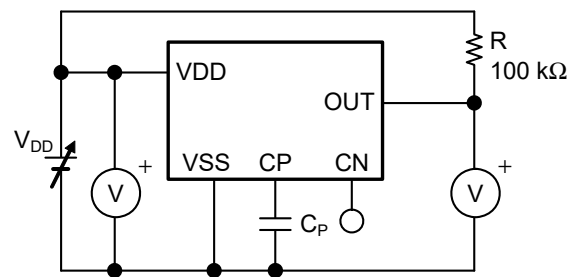
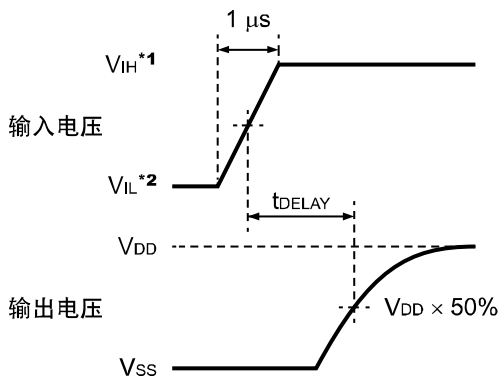
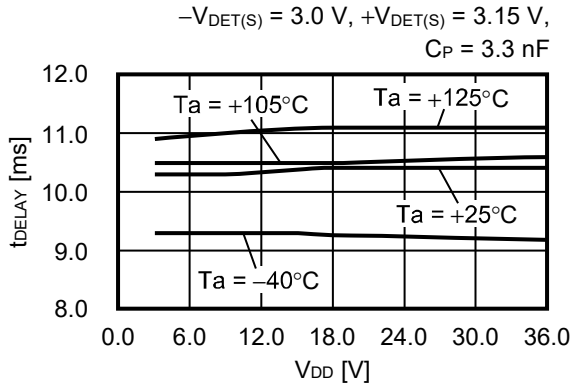


图64 解除延迟时间的测定电路

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

## 6. 解除延迟时间 ( $t_{\text{DELAY}}$ ) – 电源电压 ( $V_{\text{DD}}$ )

### 6.1 SENSE检测产品



- \*1.  $V_{\text{IH}} = +V_{\text{DET(S)}} + 0.5 \text{ V}$
- \*2.  $V_{\text{IL}} = +V_{\text{DET(S)}} - 0.5 \text{ V}$

图65 解除延迟时间的测定条件

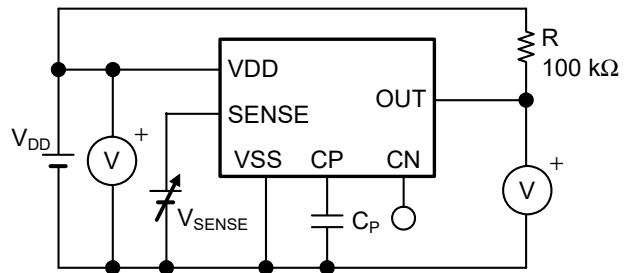


图66 解除延迟时间的测定电路

## 7. 抛负载特性 ( $T_{\text{a}} = +25^{\circ}\text{C}$ )

### 7.1 VDD检测、动态 "L" 产品

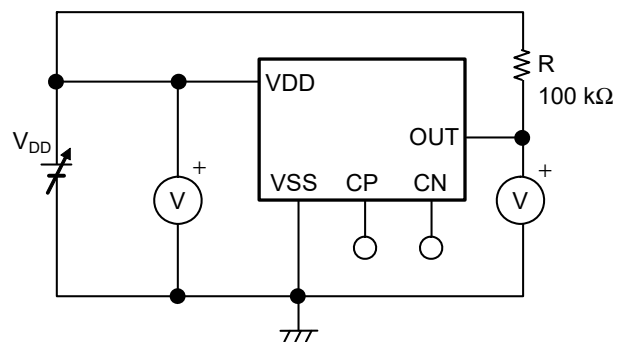
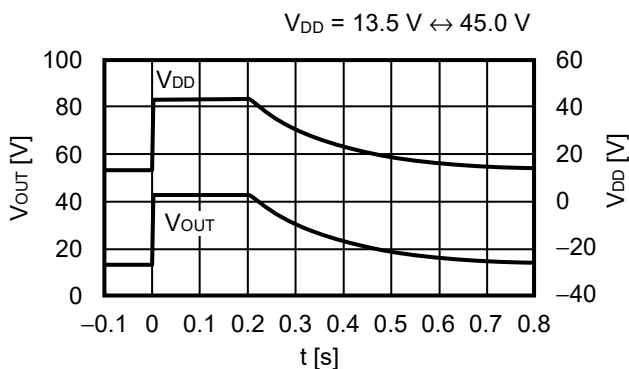


图67 抛负载特性的测定电路

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。



■ 应用电路例

1. 微机等的复位电路

在微机电脑在电源电压比最低工作电压还低的情况下，有可能执行规定以外的操作，或破坏内存寄存器的内容。另外，电源恢复到正常电位时，如果不把微机设定到规定的初始状态，会导致以后的异常工作。为了防止这样的事故，在电源的瞬间切断或者瞬间停止时一定要进行复位工作。

S-19110系列电压检测器因为最低工作电压低、检测电压精度高、并备有滞后幅度，可以如图68、图69所示，简单地构成复位电路。

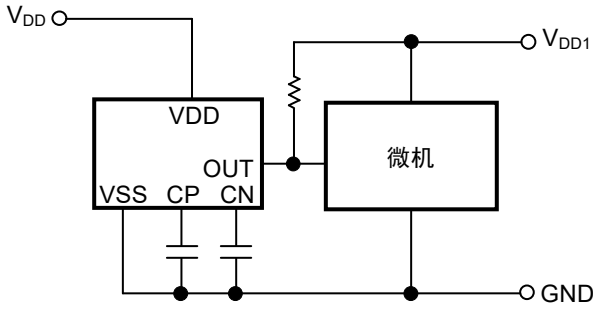


图68 复位电路示例 (VDD检测产品)

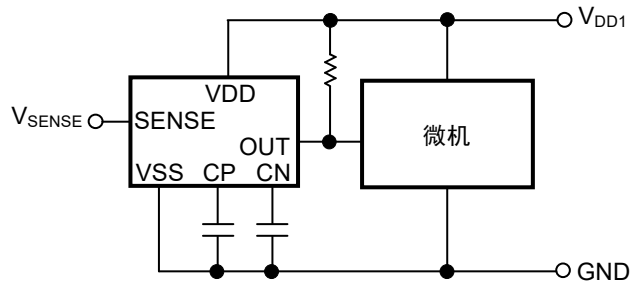
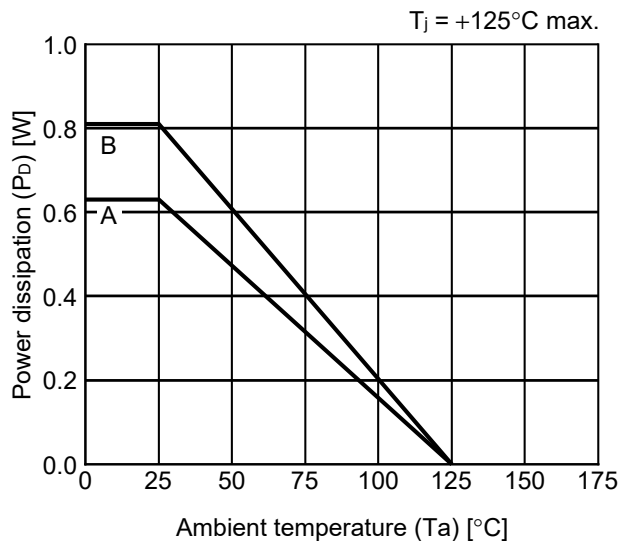


图69 复位电路示例 (SENSE检测产品)

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据，实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

■ Power Dissipation

SOT-23-6



Board	Power Dissipation (P <sub>D</sub> )
A	0.63 W
B	0.81 W
C	—
D	—
E	—

# SOT-23-3/3S/5/6 Test Board

 IC Mount Area

**(1) Board A**



Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		2
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

**(2) Board B**



Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		4
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

No. SOT23x-A-Board-SD-2.0



No. MP006-A-P-SD-2.1

TITLE	SOT236-A-PKG Dimensions
No.	MP006-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



No. MP006-A-C-SD-3.1

TITLE	SOT236-A-Carrier Tape
No.	MP006-A-C-SD-3.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



Enlarged drawing in the central part



No. MP006-A-R-SD-2.1

TITLE	SOT236-A-Reel		
No.	MP006-A-R-SD-2.1		
ANGLE		QTY	3,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

## 免责声明 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息, 有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考, 并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后, 发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害, 或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况, 本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载错误而导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时, 请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规, 测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本产品出口海外时, 请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令, 办理必要的相关手续。
7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹, 或有其他军事目的者的情况, 本公司对此概不承担任何责任。
8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件, 也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时, 或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时, 所导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等, 请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价, 客户自行判断适用的可否。
10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途, 在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本产品在一般的使用条件下, 不会影响人体健康, 但因含有化学物质和重金属, 所以请不要将其放入口中。另外, 晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐, 徒手接触时请注意防护, 以免受伤等。
12. 废弃本产品时, 请遵守使用国家和地区的法令, 合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。
14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处, 请向代理商咨询。
15. 本免责声明以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07